

**Програма V Української конференції з фізики
напівпровідників (УНКФН-5)
м. Ужгород, 9–15 жовтня 2011 р.**

9 ЖОВТНЯ, НЕДІЛЯ

Реєстрація учасників
Культурна програма

10 ЖОВТНЯ, ПОНЕДІЛОК

9⁰⁰-11⁰⁰ - Реєстрація учасників

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

11⁰⁰-11³⁰ - Виступи-вітання голів конференції, інших офіційних осіб

11³⁰-12⁰⁰ - Мачулін В.Ф., Кладько В.П.

Методи характеристики та діагностики напівпровідникових наноструктур

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна

12⁰⁰-12³⁰ - Гомоннай О.В., Маслюк В.Т., Шпеник О.Б.

Індуковані високоенергетичним опроміненням ефекти у широкозонних напівпровідниках і діелектриках

Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород, Україна

12³⁰-13⁰⁰ - Гапоненко С.В., Тихомиров С.А., Станкевич В.В., Ермоленко М.В., Буганов О.В.

Сверхбыстрые оптические нелинейности в гетероструктурах, обусловленные плотной электронно-дырочной плазмой

Інститут фізики імені Б.І. Степанова НАН Білорусі, Мінськ, Білорусь

13⁰⁰-14³⁰ - Обід

14³⁰-19⁵⁰ - ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

14³⁰-15⁰⁰ - Литовченко В.Г.

Зонні характеристики графеноподібних вуглецевих плівок

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна

15⁰⁰-15³⁰ - Стріха М.В., Васько Ф.Т., Романець П.М.

Нерівноважні носії в графені: негативна диференціальна провідність, електрооптика та модуляція випромінювання

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна

15³⁰-16⁰⁰ - Trunov M.L., Rubish V.M., Lytvyn P.M.

Alternating matter motion in photoinduced mass-transport driven and enhanced by light polarization in chalcogenide vitreous semiconductors

Uzhgorod National University, Uzhgorod, Ukraine

16³⁰-17⁰⁰ - Vlček M., Palka K., Wagner T., Koudelka L. and Mosner P.

Unique properties and functionalities of chalcogenide glasses

Department of General and Inorganic Chemistry, University of Pardubice, Pardubice, Czech Republic

17⁰⁰-17³⁰ - Tiginyanu I., Popa V.

Surface charge lithography at the micro- and nano-scales

National Center for Materials Study and Testing, Technical University of Moldova, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova

17³⁰-17⁵⁰ - Перерва на каву

17⁵⁰-18²⁰ - Kochelap V. A., Korotyeyev V. V.

Physics and theory of ballistic electron transport in nanoscale diodes: Properties in terahertz frequency range

Department of Theoretical Physics, Institute of Semiconductor Physics, Kiev, Ukraine

18²⁰-18⁵⁰ - Дмитрук М.Л.

Фотовольтаїка третього покоління: плазмони, поляритони, квантові точки і дроти

Інститут фізики напівпровідників НАН України, Київ, Україна

18⁵⁰-19²⁰ - Фреїк Д.М.

Квантово-розмірні ефекти в конденсованих наноструктурах та проблема термоелектрики

Фізико-хімічний інститут Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна

19²⁰-19⁵⁰ - Смынтина В.А., Борщак В.А.

Явления генерации и переноса в неидеальных гетероструктурах и создание на их основе сенсоров изображений нового типа

Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова, Одесса, Україна

19⁵⁰-20⁵⁰ – Вечеря

11 ЖОВТНЯ, ВІВТОРОК

9⁰⁰-11⁰⁰ - ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

9⁰⁰-9³⁰ - Блонський І.В., Дмитрук А.М., Дмитрук І.М., Кадан В.М., Коренюк П.І., Павлов І. О., Єщенко О.В., Алексєєнко А.А.

Закономірності взаємодії ультракоротких лазерних імпульсів з нанокompозитними середовищами

Інститут фізики НАН України, Київ, Україна

9³⁰-10⁰⁰ - Ткач М.В. Сеті Ю.О.

Теорія властивостей резонансно-тунельних наноструктур, як активних елементів квантових каскадних лазерів і детекторів

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

10⁰⁰-10³⁰ - Сизов Ф.Ф.

Приемники излучения от ИК до мм диапазона

Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна

10³⁰-11⁰⁰ - Юхимчук В.О., Пономарьов С.С., Джаган В.М., Валах М.Я., Новиков В.А., Красильник З.Ф.

Компонентний склад самоіндукованих GeSi nanoострівців:

Раманівська та Оже спектроскопія

Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, Київ, Україна

11⁰⁰-11³⁰ - Перерва на каву

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

СЕКЦІЯ 1

11³⁰-11⁵⁰ - Shepelskii G.A., Gasan-zade S.G., Strikha M.V.

Experimental evidence for the third level (A^+) of Hg vacancy and the photoelectromagnetic anomalies in $Hg_{1-x}Cd_xTe$

V.Lashkariov Institute of Semiconductor Physics, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

- 11⁵⁰-12¹⁰ - Evtukh A., Mimura H., Litovchenko V.G.
Quantum cathodes in electron field emission
V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, Kyiv, Ukraine
- 12¹⁰-12³⁰ - Завражнов А.Ю., Березин С.С., Протасов С.И., Рязских М.В., Косяков А.В., Сидей В.И.
«Хромотермографический» метод для уточнения T-x диаграмм систем In-S и Ga-Se
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
- 12³⁰-12⁴⁵ - Орлов Л.К., Смысллова Т.Н., Дмитрук И.Н., Штейнман Э.А., Терещенко А.Н., Вдовин В.И., Бондаренко А.С.
Механизмы роста и особенности излучательной рекомбинации наноструктурированных пленок кубического карбида кремния, выращиваемых на кремнии
ИФМ РАН, Нижний Новгород, Россия
- 12⁴⁵-13⁰⁰ - Панасюк Л.І., Єрмаков В.М., Коломоєць В.В., Назарчук П.Ф., Федосов С.А.
Міждолиніне розсіювання електронів у n-Si в області температур 300-450 К
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 13⁰⁰-14³⁰ - **Обід**
- 14³⁰-14⁵⁰ - Оліх Я.М., Мачулін В.Ф.
Акустостимульовані явища в напівпровідниках
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 14⁵⁰-15¹⁰ - Романюк Б.М., Кладько В.П., Мачулін В.Ф., Литовченко В.Г., Попов В.Г., Мельник В.П.
Процеси гетерування у сонячному кремнії: вплив кристалічної структури на фоточутливість
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 15¹⁰-15³⁰ - Данильченко Б.О.
Теплові властивості кристалів GaN
Інститут фізики НАН України, Київ, Україна
- 15³⁰-15⁴⁵ - Venger E.F., Ievtushenko A.I., Melnichuk L.Yu., Melnichuk O.V.
Surface polaritons in optically anisotropic single crystals located in a strong uniform magnetic field
Mykola Gogol State Pedagogic University, Nizhyn, Ukraine
- 15⁴⁵-16⁰⁰ - Трохимчук П.П.
Релаксаційна оптика: ретроспектива та перспективи.
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна.
- 16⁰⁰-16¹⁵ - Тягульський С.І., Тягульський І.П., Назаров О.М., Назарова Т.М., Лисенко В.С., Реболе Л., Леман Я., Скорупа В.
Температурні залежності електролюмінесценції та захоплення заряду плівок SiO₂, які імплантовані Ge та Tb
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 16¹⁵-16³⁰ - Зезюля П.А., Малевич В.Л., Манак И.С.
Влияние анизотропии фотопроводимости на генерацию терагерцовых импульсов в полупроводниках
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
- 16³⁰-16⁴⁵ - Раранский Н.Д., Олейнич-Лысюк А.В.

**Об еволюции дефектов в Cz-кремнии в процессе
низкотемпературного старения**

*Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, Черновцы,
Украина*

- 16⁴⁵-17⁰⁰ - Константинович А.В., Константинович I.A.
**Спектр випромінювання системи електронів, що рухаються вздовж
гвинтової лінії у прозорому середовищі**
Чернівецький національний університет, Чернівці, Україна

17⁰⁰-17³⁰ - **Перерва на каву**

- 17³⁰-17⁴⁵ - Рябченко С.М., Комарів А.В., Лось А.В., Романенко С.М.

**Ефекти розведеного магнітного напівпровідника в карбіді кремнію з
імплантованими іонами Mn і Fe**

Інститут фізики НАН України, Київ, Україна

- 17⁴⁵-18⁰⁰ - Golovchak R.

**Topological self-organization phenomenon in vitreous semiconductors:
experimental signatures and theoretical predictions**

Lviv Sci. & Res. Institute of Materials of SRC "Carat", Lviv, Ukraine

- 18⁰⁰-18¹⁵ - Данилюк Г.Д., Глухов К., Демків Л.С., Стахіра Й.М., Товстюк Н.К.,
Белюх В.М.

**Вплив деформації на структуру спектра власного поглинання
монокристалічного Tl₂S**

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

- 18¹⁵-18³⁰ - Андрусенко Д.А., Бурбело Р.М., Исаев Н.В., Кузьмич А.Г.

**Определение температуропроводности мезопористого кремния
фотоакустическим методом «открытого окна»**

*Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев,
Украина*

- 18³⁰-18⁴⁵ - Бурбело Р., Исаев М., Кузьмич А., Курилюк В.

**Формування діаграм направленості ФТА сигналу в неоднорідних
напівпровідникових структурах при їх імпульсному лазерному
опроміненні**

*Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ,
Україна*

- 18⁴⁵-19⁰⁰ - Буківський П.М., Гнатенко Ю.П.

**Оптические дослідження магнітних спінових кластерів та їх
температурної еволюції в спіновому склі Cd_{1-x}Mn_xTe**

Інститут фізики НАН України, Київ, Україна

- 19⁰⁰-19³⁰ - **Стенові доповіді C1.1–C1.36**

СЕКЦІЯ 4

- 11³⁰-11⁵⁰ - Yashchuk V.

**The peculiarities of electronic processes in organic semiconductors. Some
fundamental and applied aspects, bridge to biology**

Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, Ukraine

- 11⁵⁰-12¹⁰ - Dimitriev O.P., Smertenko P.S., Piryatinski Yu.P., Ogurtsov N.A., Pud A.A.
**Charge and energy transfer in organic-inorganic semiconductor hybrid
systems**

*V.Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NAS of Ukraine, Kyiv,
Ukraine*

- 12¹⁰-12³⁰ - Kökényesi S., Dmitruk N., Charnovich S.

**Photoinduced effects under surface plasmon resonance conditions in
As₂S₃/Au nanocomposite**

University of Debrecen, Debrecen, Hungary

- 12³⁰-12⁴⁵ - Минаев В.С., Тимошенко С.П., Калугин В.В., Новиков С.Н.
Количественная нанодиагностика структуры стеклообразных и нестеклообразных некристаллических полупроводников и диэлектриков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Россия
- 12⁴⁵-13⁰⁰ - Teteris J.
Photoinduced mass transport in organic and inorganic polymers
Organization Institute of Solid State Physics, University of Latvia, Riga, Latvia
- 13⁰⁰-14³⁰ - **Обід**
- 14³⁰-14⁵⁰ - Shpotyuk O.
Free volume evolution in glassy semiconductors: How far can we go with PALS technique?
Lviv Scientific Research Institute of Materials of SRC "Carat", Lviv, Ukraine
- 14⁵⁰-15¹⁰ - Kavetskyu T., Šauša O., Stepanov A.
New insight on the radiation-induced structural changes in chalcogenide glasses as revealed from PALS and Doppler broadening measurements
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych, Ukraine
- 15¹⁰-15³⁰ - Маковийчук М.И
Идентификация атомных кластеров в низкоразмерных системах методом импульсной фликкер-шумовой спектроскопии
Ярославский филиал Физико-технологического института РАН, Ярославль, Россия
- 15³⁰-15⁴⁵ - Галян В.В., Кевшин А.Г., Давидюк Г.С., Шевчук М.В.
Антистоксівська фотолюмінесценція в склоподібних сплавах системи $Ag_{0,05}Ga_{0,05}Ge_{0,95}S_2-Er_2S_3$
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна
- 15⁴⁵-16⁰⁰ - Кадан В.М., Блонський І.В., Коренюк П.І., Шпотюк О.Й., Юву М.
Нові оптичні ефекти, які супроводжують розповсюдження потужних фемтосекундних імпульсів в напівпровідникових та діелектричних керівських середовищах
Інститут фізики НАН України, Київ, Україна
- 16¹⁵-16³⁰ - Індутний І.З., Данько В.А., Минько В.І., Шепелявий П.Є., Березньова О.В., Литвин О.С.
Ефект фототравлення в тонких шарах халькогенідних скловидних напівпровідників
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ, Київ, Україна
- 16⁰⁰-16³⁰ - Конопельник О.І., Аксіментьєва О.І., Горбенко Ю.Ю.
Вплив легування на параметри перенесення заряду та структуру полімерних напівпровідників
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
- 16³⁰-16⁴⁵ - Коцак Я.Я., Куценко Я.П., Пуга П.П.
Склоутворення в системі Pb-O-Cl, структура та властивості стекол
Державне підприємство «Науково-дослідний центр екологічного маркетингу та інжинірингу» НАН України, Ужгород, Україна
- 17⁰⁰-17³⁰ - **Перерва на каву**
- 17³⁰-17⁴⁵ - Голомб Р.
Першопринципні розрахунки, фотоелектронна та поверхнево-підсилена Раман спектроскопія наночарів As_2S_3 при лазерному опроміненні
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна.
- 17⁴⁵-18⁰⁰ - Горват Г.Т., Різак В.М., Лоя В.Ю., Соломон А.М., Гасинець С.М.

Термічні властивості матеріалів для елементів фазової пам'яті Ge-Se-In

Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна

18⁰⁰-18²⁰ - Петров В.В., Крючин А.А., Костюкевич С.А.

Анализ возможностей создания рельефных наноструктур методом лазерной литографии

Институт проблем регистрации информации НАН Украины, Киев, Украина

18²⁰-18⁴⁰ - Братусь В.Я., Мельник Р.С., Шаніна Б.Д., Окулов С.М., Коломис О.Ф., Стрельчук В.В.

ЕПР і оптична спектроскопія дефектів у опромінених нейтронами кристалах 3С-SiC

Институт фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна

18⁴⁰-19³⁰ - **СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ С4.1-С4.34.**

19³⁰-20³⁰ - Вечеря

12 ЖОВТНЯ, СЕРЕДА

Секція 2

9⁰⁰-9²⁰ - Skryshevsky V.A., Serdiuk T., Zakharko Yu., Geloan A., Lysenko V.

Luminescent properties of Si and SiC nanoparticles

Institute of High Technologies, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, Ukraine

9²⁰-9⁴⁰ - Nazarov A.N., Rudenko T.E., Lysenko V.S., Colinge J.P.

Multigate and nanowire SOI MOSFETs: features of the operation and electrical characterization

Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

9⁴⁰-10⁰⁰ - Литовченко В.Г., Горбанюк Т.І., Солнцев В.С., Балабай Р.М., Мисакович Т.С., Стасюк І.В.

Каталітичні властивості напівпровідникових оксидних кластерів

Институт Фізики Напівпровідників НАН України, Київ, Україна

10⁰⁰-10²⁰ - Telbiz G.

Design and properties of inorganic and organic self-assembled nanostructures of spatially ordered in the thin mesoporous films

L.V. Pisarzhevsky Institute of Physical Chemistry NASU, Kyiv, Ukraine

10²⁰-10⁴⁰ - Дзундза Б.С., Яворський Я.С., Межиловська Л.Й., Матеїк Г.Д.

Вплив поверхні на транспортні процеси у чистих і легованих бісмутом плівках плюмбум телуриду

Фізико-хімічний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна

10⁴⁰-10⁵⁵ - Маковийчук М.И., Залуцкая А.А., Проказников А.В.

Расщепление краевых мод в наноструктурах

Ярославский филиал Физико-технологического института РАН, Ярославль, Россия

11⁰⁰-11³⁰ - **Перерва на каву**

11³⁰-11⁴⁵ - Lykakh V.A., Syrkin E. S., Galuschak I.V., Krivonos S.S.

Semiconductor functionalized nanotubes and conformation transition in molecules

NTU "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine

11⁴⁵-12⁰⁰ - Карачевцева Л.А., Кучмій С.Я., Конін К.П., Литвиненко О.О., Строук О.Л.

- Ефект Ваньє-Штарка при кімнатній температурі в двовимірних структурах макропористого кремнію з нанопокриттями**
Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 12⁰⁰-12¹⁵ - Шпилевский Э.М.
Особенности массопереноса в наноматериалах
Інститут тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, Минск, Беларусь
- 12¹⁵-12³⁰ - Головацький В., Франків І., Власенко М.
Еволюція електронного спектру у двошарових сферичних квантових точках з донорною домішкою при зміні ширини квантової ями
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернівці, Україна.
- 12³⁰-12⁴⁵ - В.О. Юхимчук¹, О.Є. Беляєв, В.С. Кисельов, І.С. Бабічук, М.Я. Валах
Оптические та структурні властивості біоморфного SiC
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 12⁴⁵-13⁰⁰ - Yaremko A.M., Yukhymchuk V.O., Dzhagan V.M., Baran J., Ratajczak H.
Crystal structure with quantum dots: micro theory and Raman scattering experiments
Institute of Semiconductor Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
- 13⁰⁰-14³⁰ - Обід**
- 14³⁰-14⁴⁵ - Е.С. Сыркин
Резонансное прохождение фононов через границу раздела двух сред
Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, Харьков, Украина
- 14⁴⁵-15⁰⁰ - Сиренко В.А., И.А. Господарев, А.В. Еременко, К.В. Кравченко, Сыркин Е.С. , Феодосьев С.Б.
Колебательные характеристики массивных образцов и нанопленок диселенида ниобия
Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, Харьков, Украина
- 15⁰⁰-15¹⁵ - Феодосьев С.Б., Господарев И.А., Гришаев В.И., Котляр А.В., Кравченко К.В., Манжелей Е.В., Сыркин Е.С.
Фононные спектры наноструктур на основе графита
Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, Харьков, Украина
- 15¹⁵-15³⁰ - Тулупенко В.Н., Беличенко Я.Г., Демедюк Р.А., Порошин В.Н., Фомина О.С.
Воздействие процесса ионизации примеси КЯ на глубину ее залегания при изменении ширины δ -слоя примеси
Донбасская государственная машиностроительная академия, Краматорск, Украина
- 15³⁰-15⁴⁵ - Товстюк Н. К., Бужук Я.М., Фоменко В. Л., Григорчак І. І., Борисюк А.К., Середюк Б. А.
Структура, намагніченість і низькотемпературний імпедансний відгук полікристалів InSe, інтеркальованих нікелем
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна.
- 15⁴⁵-16⁰⁰ - Сминтина В.А., Кулініч О.А., Яцунский І.Р., Марчук І.А.
Визначення фізичних основ методів формування квантових точок та їх фотолюмінісцентні властивості

- 16¹⁵-16³⁰ - *Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса, Україна*
Аксіментьєва О.І., Оленич І.Б., Монастирський Л.С., Павлик М.Р.
Електрохромний ефект у фотолюмінесцентних гібридних структурах поліанілін – поруватий кремній
- 16³⁰-16⁴⁵ - *Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна*
Пелешак Р.М., Бачинський І.Я., Шуптар Д.Д.
S-подібні вольт-амперні характеристики діодів Шотткі з вбудованим шаром квантових точок
- 16⁴⁵-17⁰⁰ - *Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна*
Данилов Л.В., Зегря Г.Г.
Безызлучательная рекомбинация в гетероструктурах с глубокими квантовыми ямами
- 17⁰⁰-17³⁰ - *Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия*
Перерва на каву
- 17³⁰-17⁴⁵ - *Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна*
Будзуляк С. І., Єрмаков В. М., Калитчук С. М., Корбутяк Д. В.
Електролюмінесценція нанокристалів CdTe, інкорпорованих у полімерну матрицю
- 17⁴⁵-18⁰⁰ - *Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна*
Крюченко Ю.В., Корбутяк Д.В., Купчак І.М., Саченко А.В.
Вплив плазмонних збуджень металевих наночастинок на ефективність екситонної фотолюмінесценції суміжних напівпровідникових квантових точок
- 18⁰⁰-18¹⁵ - *Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна*
Купчак І. М., Корбутяк Д. В., Калитчук С. М., Крюченко Ю. В.
Зсув Стокса в нанокристалах A₂B₆, синтезованих в колоїдних розчинах та інкорпорованих в полімерні матриці
- 18¹⁵-18³⁰ - *Інститут фізики імені Б.І. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь*
Понявина А.Н., Дынич Р.А., Замковец А.Д.
Эффекты ближнего поля в органических полупроводниковых матрицах при их допировании плазмонными наночастицами
- 18³⁰-19⁰⁰ - **Стенові доповіді C2.1–C2.40**
- 19³⁰-20³⁰ - **Вечеря**

СЕКЦІЯ 4

- 9⁰⁰-9¹⁵ - *Класический приватный университет, Запорожье, Украина*
Таланин И.Е., Таланин В.И., Устименко Н.Ф.
Новая технология исследования дефектообразования во время роста бездислокационных монокристаллов кремния
- 9¹⁵-9³⁰ - *Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна*
Клюй М.І., Кладько В.П., Макаров А.В., Темченко В.П., Гришков О.П., Юхимчук В.О., Янчук І.Б.
Новий метод формування мікро- та наноструктурованих шарів кремнію та їх властивості
- 9³⁰-9⁴⁵ - *Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна*
Павлик Б.В., Слободзян Д.П., Грипа А.С., Лис Р.М., Шикоряк Й.А., Дідик Р.І.

- Вплив дефектного стану поверхні кристалів кремнію на характеристики поверхнево-бар'єрних структур**
Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
 9⁴⁵-10⁰⁰ - Дружинін А.О., Мар'ямова І.Й., Кутраков О.П., Лях-Кагуй Н.С.
Деформаційно-стимульовані ефекти в мікрочастинках кремнію р-типу за низьких температур
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
- 10⁰⁰-10¹⁵ - Мазинов А.С., Бахов В.А.
Антиотражающая структура на основе наноразмерных кремниевых слоев
Таврійський національний університет ім.В.І.Вернадського, Сімферополь, Україна
- 10¹⁵-10³⁰ - Ковтун Г.П., Кондрик А.И., Даценко О.А.
Тепловые поля и распределение примесей при выращивании кристаллов «солнечного» кремния методами направленной кристаллизации
Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», Харьков, Украина
- 10³⁰-10⁴⁵ - Зубко Є., Швець Є.
Розробка математичної імітаційної моделі технологічного процесу виготовлення пористого кремнію з застосуванням хімічних методів
Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя, Україна
- 11⁰⁰-11³⁰ - **Перерва на каву**
 11³⁰-11⁴⁵ - Бродин М.С., Волков В.И., Ляховецкий В.Р., Руденко В.И., Пузиков В.М., Семенов А.В.
Нелинейно-оптические и структурные свойства нанокристаллических пленок карбида кремния
Институт фізики НАН України, Київ, Україна
- 11⁴⁵-12⁰⁰ - Калабухова Е.Н., Савченко Д.В., Шанина Б.Д.
Исследование спиновой связи между донорами азота и электронами проводимости в высоколегированном 4H SiC n-типа методом ЭПР
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарьова НАН Украины, Киев, Украина
- 12⁰⁰-12¹⁵ - Оксанич А.П., Притчин С.Э.
Метод и аппаратура измерения внутренних термоупругих напряжений в германии
Кременчугский национальный университет им. Михаила Остроградского, Кременчуг, Украина
- 12¹⁵-12³⁰ - Стріха М.В., Бойко В.А., Гасан-заде С.Г., Старий С.В., Шепельський Г.А.
Механізми рекомбінації в пружно деформованих Cd_xHg_{1-x}Te і InSb: збільшення квантового виходу міжзонного випромінювання, зміна перерізів захоплення носіїв глибокими центрами
Институт фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 12³⁰-12⁴⁵ - Ижнин И.И., Ижнин А.И., Савицкий Г.В., Мудрый Р.Я., Дворецкий С.А., Варавин В.С., Михайлов Н.Н., Сидоров Ю.Г., Якушев М.В., Стахира И.М., Фицыч Е.И., Мынбаев К.Д., Поцяск-Белый М.
Исследование влияния отжига на дефектную структуру МЛЭ пленок CdHgTe с помощью ионного травления
Научно-производственное предприятие «Карат», Львов, Украина
- 12⁴⁵-13⁰⁰ - Курик А. О., Корбутяк Д. В., Паранчич Л. Д., Калитчук С. М., Андрійчук М. Д., Романюк А. С., Романюк О. С., Танасюк Ю. В.

Низькотемпературні дослідження фотолюмінесценції високоомних кристалів CdTe:Ti, CdTe:V, Cd_xHg_{1-x}Te:V, Mn

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

13⁰⁰-14³⁰ - Обід

14³⁰-14⁴⁵ - Mitsa V., Holomb R, Veres M., Ivanda M., Fekeshgazi I., Stronsky A. Marton A.

Nonlinear-optical TPA light absorption and energy structure of photonic glasses at changing of local coordination

Uzhhorod National University, Research Institute of Solid State Physics and Chemistry, Uzhhorod, Ukraine

14⁴⁵-15⁰⁰ - Ilchenko V.V., Bunak S.V., Marin V.V., Tkachenko V.V., Tretyak O.V., Shkavro A.G., Dvurechenskii A.V., Zinovieva A.F.

Investigation of the differential capacitance of p-i-n diodes on basis of Si with Ge quantum dots in the space charge region

Institute of High Technology, Kiev National Taras Shevchenko University, Kiev, Ukraine

15⁰⁰-15¹⁵ - Чухненко П.С., Томашик В.М., Стратійчук І.Б., Томашик З.Ф.

Хіміко-механічне полірування нелегованого та легovanого CdTe травниками (NH₄)₂Cr₂O₇-HCl-цитратна кислота/етиленгліколь

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Київ, Україна

15¹⁵-15³⁰ - Британ В.Б., Пелешак Р.М., Корбутяк Д.В.

Механізми пасивації атомарним воднем електрично-активних центрів у телуриді кадмію та цинку

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна

15³⁰-15⁴⁵ - Томашик З.Ф., Іваніцька В.Г., Томашик В.М.

Умови полірування поверхні CdTe (110) йодвмісними травниками

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Київ, Україна

15⁴⁵-16⁰⁰ - Раранський М.Д., Балазюк В.Н., Мельник М.І., Скицько А. І.

Залежність анізотропії пружності монокристалів Hg_{1-x}Mn_xTe і Cd_{1-x}Mn_xTe від концентрації Mn

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Чернівці, Україна

16⁰⁰-16¹⁵ - Наконечний І.Й., Копач О.В., Фочук П.М., Панчук О.Е.

Термообробка кристалів Cd_{0,9}Zn_{0,1}Te

Чернівецький національний університет, Чернівці, Україна

16¹⁵-16³⁰ - D.M. Zayachuk, V.I. Mikityuk, V.V. Shlemkevych, and D. Kaczorowski

Diagnosing of state of the Eu impurities into the PbTe:Eu doped crystals by magnetic methods

Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

16³⁰-16⁴⁵ - Буланый М.Ф., Коваленко А.В., Омельчук А.Р., Морозов А.С.,

Прокофьев Т.А.

Механизмы возбуждения фотолюминесценции в кристаллах ZnS:Mn

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара,

Дніпропетровськ, Україна

16⁴⁵-17⁰⁰ - Парасюк О.В., Калуж О.З., Білінський Ю.М., Мирончук Г.Л.

Одержання оптичних елементів із ZnSe

Національний університет "Львівська Політехніка, Львів, Україна

17⁰⁰-17³⁰ - **Перерва на каву**

17³⁰-17⁴⁵ - Стахіра Й.М.

Модуляція електронних станів деформацією шаруватого кристалу

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна

- 17⁴⁵-18⁰⁰ - Фекешгазі І.В., Коломис О.В., Сіденко Т.С.
Вплив порушення стехіометрії на комбінаційне розсіяння світла кристалами дифосфіду кадмію тетрагональної сингонії
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Київ, Україна
- 18⁰⁰-18¹⁵ - Клюй М.І., Ліптуга А.І., Лозінський В.Б., Лук'янов А.М., Тербан В.А.
Вплив плазмової обробки на оптичні властивості структур а-С:H:N-GaAs в інфрачервоній області спектру
Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є.Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 18¹⁵-18³⁰ - Burunkova J. A., Denisyuk I.Yu., Vorzobova N.D., Bulgakova V.G.
Investigation of technology and self-organizing processes on ZnO and SiO₂ polymeric nanocomposites
Saint-Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and Optics, Saint-Petersburg, Russia
- СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ С4.35–С4.70.**
19³⁰-20³⁰ - Вечеря

13 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР

СЕКЦІЯ 3

- 9⁰⁰-9²⁰ - Костилюв В.П.,
Кремнієві фотоперетворювачі сонячної енергії на основі багатобар'єрних дифузійно-польових структур
Інститут фізики напівпровідників ім. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 9²⁰-9⁴⁰ - Лепіх Я.І., Іванченко І.О., Будіянська Л.М.
Hg_{1-x}Cd_xTe у якості чутливого елемента фотоперетворювача дальньої ІЧ-області спектру
Міжвідомчий науково-навчальний фізико-технічний центр МОН і НАН України при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова, Одеса, Україна
- 9⁴⁰-10⁰⁰ - Никируй Л.І., Дзумедзей Р.О., Гевак Т.П.
Механізми розсіювання носіїв струму у легованих кристалах PbTe:Pt (In, Ga)
Фізико-хімічний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
- 10⁰⁰-10²⁰ - Sokolov V. N.
Bloch oscillations in semiconductor superlattices and the problem of generation of terahertz radiation
Institute for Semiconductor Physics, Kiev, Ukraine
- 10²⁰-10⁴⁰ - Косяченко Л.А.
Вимоги до параметрів CdZnTe як матеріалу для детекторів іонізуючого випромінювання
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
- 10⁴⁰-11⁰⁰ - Горбань А.Н., Кравчина В.В., Гомольський Д.М.
Особливості формування силових напівпровідникових приладів на епітаксійних структурах кремнію
Класичний приватний університет, Запоріжжя, Україна
- 11⁰⁰-11³⁰ - **Перерва на каву**
11³⁰-11⁴⁵ - Орлов Л. К., Орлов М. Л., Мельникова А.А., Horvath Zs., Неверов В.Н., Петухов Д.С.

- Распределение потенциала и особенности протекания токов в Si/SiGe транзисторной гетероструктуре с высоким уровнем легирования и различным характером упругих напряжений в слоях системы**
ИФМ РАН, Нижний Новгород, Россия
- 11⁴⁵-12⁰⁰ - Білобров Д.О., Козинець О.В., Литвиненко С.В., Ничипорук О.І., Скришевський В.А.
Сенсорні структури на основі кремнієвого *p-n* переходу з зустрічними гребінчастими контактами на тильній поверхні
Київський університет ім. Т. Шевченка, Київ, Україна
- 12⁰⁰-12¹⁵ - Смынтына В.А., Иванченко И.А., Сантоний В.И., Будиянская Л.М.
Опτικο-локационный измеритель коэффициента направленного отражения
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Одесса, Украина
- 12¹⁵-12³⁰ - Войцеховский А.В., Галипов Н.Х., Ижнин И.И.
Сравнение результатов ионной имплантации и ионного травления варизонных эпитаксиальных структур HgCdTe
Томский государственный университет, Томск, Россия
- 12³⁰-12⁴⁵ - Salzenstein P., Cholley N., Abbé P., Lardet-Vieudrin F., Sojdr L., Kuna A.
Ultrastable distributed radio-frequency quartz oscillator based signal
Frache Comté Electronique Thermique Optique Sciences et Technologies, Besançon, France
- 12⁴⁵-13⁰⁰ - Петряков В.А., Апатская М.В., Кухтарук Н.И., Сизов Ф.Ф., Смолий М.И.
Микрополосковые антенны миллиметрового диапазона с БГЭ на основе КРТ
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 13⁰⁰-14³⁰ - **Обід**
- 14³⁰-14⁴⁵ - Sohatsky V., Shulimov Y., Kolesnik S.
Spin valve effect on output current of spin transistor
T. Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, Ukraine
- 14⁴⁵-15⁰⁰ - Критская Т.В., Кудина О.Е., Трубицын Ю.В.
Пути снижения деградации электрофизических параметров кристаллического кремния для ФЭП
Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье, Украина
- 15⁰⁰-15¹⁵ - Brus V.V., Plashchuk M.I., Kovalyuk Z.D., Maryanchuk P.D.
Electrical properties of a photosensitive heterojunctio *n-TiO₂/p-CdTe*
Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, NAS of Ukraine, Chernivtsi Branch, Chernivtsi, Ukraine
- 15¹⁵-15³⁰ - Сахно М.В., Гуменюк-Сичевська Ж.В., Сизов Ф.Ф.
Моделювання антени ТГц діапазону для HgCdTe детектора на розігріві електронного газу
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 15³⁰-15⁴⁵ - Голенков О.Г., Бут Д.Б., Сизов Ф.Ф., Рева В.П., Писаренко Л.О., Станиславский А.С.
Вплив температури на чутливість приймача випромінювання міліметрового/субміліметрового діапазону спектру на основі кремнієвого польового транзистору
Інститут фізики напівпровідників НАН України ім. В.Є. Лашкарьова, Київ, Україна
- 15⁴⁵-16⁰⁰ - Мележик Е.А., Гуменюк-Сычевская Ж.В.

Релаксация электронов в КЯ CdTe/Hg_{1-x}Cd_xTe/CdTe с инвертированной зонной структурой при T=77 К

Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины, Киев, Украина

16⁰⁰-16¹⁵ - Krukovsky S., Sukach A., Tetyorkin V., Mrykhin I., Mykhashchuk Y.

Characterization and performance of InP/InGaAsP double heterostructures

Scientific Research Company "Carat", Lviv, Ukraine

16¹⁵-16³⁰ - Tkachuk A., Tetyorkin V., Sukach A., Boiko V., Stariy S.

Defect states in CdTe polycrystalline films

Kirovohrad Volodymyr Vynnychenko State Pedagogical University, Kirovohrad, Ukraine

16³⁰-16⁴⁵ - Рева В.П., Сизов Ф.Ф., Голенков А.Г., Коринец С.В.

Принципы построения многоэлементных детекторов субмиллиметрового диапазона на основе кремниевой КМОП технологии

Институт физики полупроводников НАНУ им. В.Е. Лашкарьова, Киев, Украина

16⁴⁵-17⁰⁰ - Алиев Р.У., Мухтаров Э.К., Алиев С.

Фотоэлектрические генераторы с вертикальным p-n-переходом на поликристаллической кремниевой основе

Андижанский государственный университет, Андижан, Узбекистан

17⁰⁰-17³⁰ - **Перерва на каву**

17³⁰-17⁴⁵ - Когут І.Т., Дружинін А.О., Голота В. І., Довгий В.В.

Элементы аналитичних мікросистем-на-кристалі на основі тривимірних КНІ-структур

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника, Івано-Франківськ, Україна

17⁴⁵-18⁰⁰ - Марков Д.А., Коровай А.В., Хаджи П.И.

Генерация (усиление) терагерцового излучения при резонансном возбуждении экситонов в полупроводниках

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь, Молдова

18⁰⁰-18¹⁵ - Косяченко Л.А., Грушко Є.В., Рошко В.Я.

Рекомбінаційні втрати на поверхнях поглинаючого шару в сонячному елементі CdS/CdTe

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

18¹⁵-18³⁰ - Зайцев Р.В., Копач В.Р., Кіріченко М.В.

Еволюція часу життя нерівноважних носіїв заряду в кремнієвих фотоелектричних перетворювачах під дією магнітного поля

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна

18³⁰-18⁴⁵ - Войцеховский А.В., Горн Д.И., Ижнин И.И., Ижнин А.И., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А.

Наблюдение и анализ фотолюминесценции гетероструктуры Cd_xHg_{1-x}Te с одиночной квантовой ямой

Томский государственный университет, Томск, Россия

18³⁰-19³⁰ - **Стенові доповіді С3.1–С3.43**

19³⁰-20³⁰ - **Вечеря**

СЕКЦІЯ 4

9⁰⁰-9¹⁵ - Ю.Ф. Ваксман, Ю.А. Ницук, Ю.Н., В.В. Яцун

- Исследование оптических свойств кристаллов ZnS, легированных железом**
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, Україна
 9¹⁵-9³⁰ - Клочко Н.П., Хрипунов Г.С., Волкова Н.Д., Копач В.Р., Любов В.М., Клепікова К.С., Копач А.В.
- Вирощування 1D наноструктур цинк оксиду методом імпульсного електрохімічного осадження**
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна
 9³⁰-9⁴⁵ - Rokutnyi S.I., Rokutnyi M.S., Shpak A.P., Uvarov V.N.
- Theory of exciton states in semiconductor quantum dots**
Institute of Metal Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
- 9⁴⁵-10⁰⁰ - Жиляєв Ю.В., Микулик Д.И., Алексеев П.А., Орлова Т.А., Полетаев Н.К., Сныткина С.А., Федоров Л.М.
- Ультра-чистые слои GaAs для детекторных p-i-n структур**
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
- 10⁰⁰-10¹⁵ - Н.Л. Дон, Г.П. Чуйко
- Комп'ютерне моделювання способів упорядкування стехіометричних вакансій у шаруватих сполуках A₃B₂^{IV}**
Херсонський національний технічний університет, Херсон, Україна
- 10¹⁵-10³⁰ - Рогозин И.В., Котляревский М.Б.
- Структура и свойства нанокристаллических слоев ZnO легированных фосфором**
Бердянский государственный педагогический университет, Бердянск, Украина
- 10³⁰-10⁴⁵ - Матяш І.Є., Максименко Л.С., Міщук О.М., Руденко С.П., Сердега Б.К.
- Модуляційно-поляризаційна діагностика наноструктурованих композитних плівок**
Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 11⁰⁰-11³⁰ - **Перерва на каву**
- 11³⁰-11⁴⁵ - Сиротюк С.В., Швед В.М.
- Зміна електронної структури твердих розчинів GaAlN під впливом домішок марганцю і водню**
Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна
- 11⁴⁵-12⁰⁰ - Мирончук Г.Л., Парасюк О.В., Якимчук О.В., Данильчук С.П.
- Одержання та властивості монокристалів AgGaGe₂S₂Se₄**
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна
- 12⁰⁰-12¹⁵ - Ievtushenko A.I., Lashkarev G.V., Tkach V.M., Strelchuk V.V., Khyzhun O.Y., Lazorenko V.I., Klochkov L.O., Bryksa V.P., Avramenko K.A., Baturin V.A., Karpenko A.Y.
- The effect of nitrogen doping and Al-N codoping on ZnO properties**
Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, NASU, Kyiv, Ukraine
- 12¹⁵-12³⁰ - Буджак Я.С., Зуб О.В.
- Ефект Зеебека – важлива характеристика для діагностики напівпровідникових кристалів та прогнозування їх властивостей**
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
- 12³⁰-12⁴⁵ - Вірт І.С., Гадзаман І.В., Рудий І.О., Фружинський М.С., Курило І.В., Лопатинський І.Є.
- Властивості тонких плівок ZnO, MgO і Zn_{1-x}Mg_xO, отриманих імпульсним лазерним осадженням**

- Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна*
- 12⁴⁵-13⁰⁰ - Надькин Л. Ю., Хаджи П.И.
Rmp-probe –метод исследования оптических свойств полупроводника в экситонной области спектра в нестационарном режиме при учете упругого экситон-экситонного взаимодействия
Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, Тирасполь, Молдова
- 13⁰⁰-14³⁰ - **Обід**
 14³⁰-14⁴⁵ - Височанський Ю.М., Глухов К.С., Федько Х.В., Когутич А.А., Майор М.М., [Пріц І.П.]
Електронна структура, фазовий перехід та перенесення заряду в сегнетоелектрику-напівпровіднику Sn₂P₂S₆
Кафедра фізики напівпровідників, НДІ фізики і хімії твердого тіла, Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- 14⁴⁵-15⁰⁰ - Гадзаман І.В., Клим Г.І., Фартушок М.М., Станько М.Г., Штим В.С.
Структура та електричні властивості напівпровідникової кераміки Zn_{0.1}Co_{0.32}Li_{0.5}Ni_{0.5}Mn_{1.58}O₄
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна
- 15¹⁵-15³⁰ - Павлович І.І., Томашик В.М., Томашик З.Ф., Стратійчук І.Б., Копил О.І.
Формування полірованої поверхні кристалів на основі Bi₂Te₃ травниками H₂O₂-HBr-модифікатор в'язкості
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Е. Лашкарьова, Київ, Україна
- 15³⁰-15⁴⁵ - Yaremko A.M., Lashkarev G.V., Karpyna V.A.
Investigation of LO-phonon excitations in ZnO films by Raman spectroscopy
V.E.Lashkarev Institute for Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
- 15⁴⁵-16⁰⁰ - Lashkarev G.V., Karpyna V.A., Lazorenko V.I., Ievtushenko A.I., Khranovskyy V.D., Shteplyuk I.I., Demydyuk P.V., Khomchenko V.S.
Properties of ZnO Films and Nanostructures for Optoelectronic Applications
M.Frantsevich Institute for Problems of Material Science, NASU, Kyiv, Ukraine

СЕКЦІЯ 2

- 16¹⁵-16³⁰ - Пелешак Р.М., Даньків О.О., Кузик О.В.
Механізми формування дефектно-деформаційних кластерів у гетероструктурі під дією ультразвукової хвилі
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна
- 16³⁰-16⁴⁵ - Zayachuk D.M., Slobodskyy T., Astakhov G.V., Slobodskyy A.
Photoluminescence of the ZnSe based semimagnetic quantum structures
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
- 16⁴⁵-17⁰⁰ - Глухов К.Е., Шнайдер М., Берча Д.М.
Аномальная анизотропия слоистых халькогенидов
Ужгородский национальный университет, Ужгород, Україна
- 17⁰⁰-17³⁰ - **Перерва на каву**
 17³⁰-17⁴⁵ - Марков Д.А., Коровай А.В., Хаджи П.И., Белоусов И.В.
Взаимодействие тонкой полупроводниковой плёнки с фазово-модулированным УКИ лазерного излучения в экситонной области спектра при высоком уровне возбуждения и оптический аналог Фешбах-резонанса

- Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь, Молдова*
 17³⁰-17⁴⁵ - Freik D.M., Yurchyshyn I.K., Harun L.T., Lysiuk Yu.V.
Size oscillatory effects of kinetic coefficients in nanostructures based on compounds IV-VI
Physical-chemical institute at the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine
- 17⁴⁵-18⁰⁰ - Птащенко О.О., Дойчо І.К., Гевелюк С.А., Ришякевич-Пасек Е.
Особливості довгочасової еволюції кластерів CdS всередині шпаристого скла після γ -опромінення
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, Україна
- 18⁰⁰-18¹⁵ - Филь Д.В., Пикалов А.А.
Сверхтекучие свойства магнитоэкситонов в графеновых гетероструктурах
Институт монокристаллов НАН Украины, Харьков, Украина
- 18¹⁵-18³⁰ - Кочелап В. О., Кухтарук С. М.
Взаємодія електронів, дрейфуючих у квантовій ямі, з віддаленою наночастинкою
Институт фізики напівпровідників НАН України, Київ, Україна
- 18³⁰-18⁴⁵ - О.Ф. Васильева, П.И. Хаджи
Теория параметрических осцилляций в микрорезонаторе
Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко, Тирасполь, Молдова
- 18⁴⁵-19⁰⁰ - Матвеева Л.А., Нелюба П.Л., Колядина Е.Ю.
Сильные встроенные электрические поля в наноструктурных гетеросистемах
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины, Киев, Украина
- 19⁰⁰-19¹⁵ - Герасимчук А. И.
Молекулярно-динамические принципы самосборки наноструктур при химическом осаждении их газовой фазы
Институт общей и неорганической химии им. В.И.Вернадского НАН Украины, Киев, Украина
- 18³⁰-19⁰⁰ - **СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ С4.71–С4.124**
 19³⁰-20³⁰ - Вечеря

14 ЖОВТНЯ, П'ЯТНИЦЯ

СЕКЦІЯ 3

- 9⁰⁰-9¹⁵ - Косяченко Л.А., Aoki T., Fiederle M., Diegues E., Склярчук В.М.,
Масляничук О.Л., Склярчук О.В.
Особливості процесу самокомпенсації в напівізолюючих кристалах CdTe і Cd_{0,9}Zn_{0,1}Te
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
- 9¹⁵-9³⁰ - Гадзаман І.В.
Одержання методом твердофазових реакцій наноструктурованих оксишпінельних керамічних матеріалів та перспективи їх використання
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна
- 9³⁰-9⁴⁵ - Силенко П.М., Данько Д.Б., Шлапак А.М., Солонін Ю.М.
Синтез плівок TiO₂, їх структура та морфологія поверхні

- Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ, Україна*
- 9⁴⁵-10⁰⁰ - Бушма О. В.
Моделювання динамічного збудження світлодіодної матриці при синтезі шкального зображення
Інститут фізики напівпровідників НАН України, Київ, Україна.
- 10⁰⁰-10¹⁵ - Костильов В. П., Мелак В. Г., Дверніков Б. Ф.
Багатобар'єрні кремнієві дифузійно-польові фотоперетворювачі сонячної енергії при концентрованому випромінненні
Інститут фізики напівпровідників ім. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 10¹⁵-10³⁰ - Велешук В. П., Власенко О. І., Киселюк М. П., Ляшенко О. В.
Вплив підвищення струму та температури на випромінюючі характеристики потужних GaN світлодіодів
Інститут фізики напівпровідників ім. В. С. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 10³⁰-10⁴⁵ - Перевертайло В. Л., Тарасенко Л. І., Перевертайло О. В., Шкіренко Е. А., Крюков О. С., Віроzub Т. М., Ковригін В. І.
Кремнієвий p-i-n фотоприймач з підвищеною чутливістю в УФ діапазоні випромінювання
ДП НДІ мікроприладів НТК «ІМК» НАНУ, Київ, Україна
- 10⁴⁵-11⁰⁰ - Ляшенко О. В., Власенко О. І., Мягченко Ю. О., Сагань Я. І., Онанко А. П., Киселюк М. П., Велешук В. П.
Вплив покрокового навантаження на деградацію та спектри випромінення потужних InGaN/GaN світлодіодів
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
- 11⁰⁰-11³⁰ - **Перерва на каву**
- 11³⁰-11⁴⁵ - Костильов В. П., Саченко А. В., Соколовський І. О., Черненко В. В.
Вплив експоненціально розподілених поверхневих центрів на швидкість поверхневої рекомбінації та на параметри кремнієвих сонячних елементів.
Інститут фізики напівпровідників ім. В. С. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 11⁴⁵-12⁰⁰ - О. В. Ляшенко, О. І. Власенко, М. П. Киселюк, В. П. Велешук
Локальні просторові флуктуації квантового виходу гетеропереходу
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
- 12⁰⁰-12¹⁵ - Шапар В. М., Свечніков С. В., Савчук А. В., Бондаренко А. В.
Фотоприймальний пристрій з низьким порогом чутливості
Інститут фізики напівпровідників ім. В. С. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 12⁰⁰-12¹⁵ - Борковська Л. В., Корсунська Н. О., Чернокур Г., Остапенко С.
Особливості фотолюмінесценції структур з квантовими точками CdSe/ZnS і CdSeTe/ZnS, спряженими з антитілами
Інститут фізики напівпровідників ім. В. С. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 12¹⁵-12⁴⁵ - Коротєєв В. В., Кочелап В. О.
«Плазмонні» коливання двовимірного електронного газу у випадку сильної анізотропії функції розподілу носіїв
Інститут фізики напівпровідників імені В. С. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- 13⁰⁰-14³⁰ - **Обід**

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

14³⁰-15⁰⁰ - Райчев О. Э.

Топологические диэлектрики: новый класс материалов

*Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины,
Киев, Украина*

15⁰⁰-15³⁰ - Andriesh A., Iovu M., Culeac I., Nistor Iu., Meshalkin A., Benea V., Robu Şt.,
Dragalina G., Popuşoi A., Mitcov D., Cozma C.

**Optical properties of nanocomposite materials based on organic
copolymers grafted with isothiocyanatochalcones and phthalocyanine
derivatives**

*Institute of Applied Physics of Academy of Sciences of Moldova,
Chisinau, Republic of Moldova*

15³⁰-16⁰⁰ - Бойчук В.І., Білінський І.В., Лешко Р.Я., Турянська Л.М.

**Вплив донорної та акцепторної домішок на оптичні властивості
сферичної квантової точки**

*Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
Дрогобич, Україна*

16⁰⁰-16³⁰ - Krivoruchko V.N., Tarenkov V. Yu., Varyukhin D.V., Pashkova O.N.

**Dilute magnetic semiconductors (In,Mn)Sb and (In,Mn,Zn)Sb:
Unconventional magnetism and transport properties**

Donetsk Physics and Technology Institute NAS of Ukraine, Donetsk, Ukraine

16³⁰-17⁰⁰ - Коваленко О.В., Корбутяк Д.В.

Випромінюючі квантово-розмірні структури на базі сполук A_2B_6 .

*Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,
Дніпропетровськ, Україна*

17⁰⁰-17³⁰ - Перерва на каву

17³⁰ ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ

СЕКЦІЯ 1

- C1.1. Губа С. К., Юзевич В.М., Курило І.В.
Характер температурних змін фізичних характеристик поверхневого шару квантових точок InAs
Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна
- C1.2. Хандецький В.С., Тонкошкур Ю.О., Мартинович Л.Я.
Безконтактні вимірювання електричної провідності напівпровідникових плівок
Дніпропетровський національний університет ім.О.Гончара, Дніпропетровськ, Україна
- C1.3. Степанчиков Д.
Можливість генерації когерентних станів екситонів у фосфідах $A_3^{II}B_2^V$
Херсонський національний технічний університет, Херсон, Україна
- C1.4. Луньов С.В., Назарчук П.Ф., Панасюк Л.І.
Про параметри Δ_1 –мінімумів в n-Ge
Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
- C1.5. Кевшин А.Г., Галян В.В., Давидюк Г.Є., Шевчук М.В.
Вплив температури на фотолюмінесцентні властивості склоподібних сплавів системи $Ag_{0,05}Ga_{0,05}Ge_{0,95}S_2-Er_2S_3$
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна
- C1.6. Єрмаков В.М., Коломоєць В.В., Назарчук П.Ф., Панасюк Л.І., Федосов С.А.
Тензорезистивні ефекти у сильно деформованих слабоізоляторних кристалах p-Si(B) при T=4,2 К
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- C1.7. Блецкан Д.И., Глухов К.Е., Кабаций В.Н., Вакульчак В.В.
Электронная структура кристаллического и стеклообразного GeS_2
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C1.8. Блецкан Д. И., Глухов К. Е., Кабаций В. Н.
Электронная структура кристаллов GeSe с вакансиями германия и примесью висмута по данным квантово-химических *ab initio* расчетов и экспериментов по фотопроводимости
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C1.9. Блецкан М.М., Глухов К.Е., Грабар А.А.
Влияние полиморфизма на электронную структуру SnS
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C1.10. Губа С. К., Юзевич В.М., Курило І.В.
Характер температурних змін фізичних характеристик поверхневого шару квантових точок InAs
НУ “Львівська політехніка, Львів, Україна
- C1.11. Ящинський Л.В., Коваль Ю.В., Федосов С.А., Захарчук Д.А.
Вплив опромінення на фізичні властивості монокристалів антимоніду кадмію
Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
- C1.12. Мар’ян В.М., Козусенок О.В., Кириленко В.К., Тарнай А.А., Туряниця І.І., Рубіш В.М.
Фазові перетворення в халькогенідних стеклах та аморфних плівках
Ужгородський НТЦ МОНІ ІПРІ НАН України, Ужгород, Україна
- C1.13. Студеняк І.П., Ізай В.Ю., Панько В.В., Kúř P., Plectenik A., Zahoran M., Greguš J., Roch T.

- Люмінесценція та край оптичного поглинання в імплантованих фосфором кристалах $\text{Cu}_6\text{PS}_5\text{I}$**
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C1.14. Студеняк І.П., Пономарьов В.Є., Кранґєс М., Мінець Ю.В., Сусліков Л.М.
Особливості композиційного розупорядкування в кристалах твердих розчинів $\text{Cu}_6\text{PS}_5\text{I}_{1-x}\text{Cl}_x$
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C1.15. Горбенко В.І.
Дослідження умов поверхневої дифузії атомів водню, вуглецю та кисню на графені
Класичний приватний університет, Запоріжжя, Україна
- C1.16. Буківський П.М., Гнатенко Ю.П., Фарина І.О., Гамерник Р.В., Опанасюк А.С., Косяк В.В.
Оптичні, фотоелектричні та структурні властивості полікристалічних плівок $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$
Інститут фізики НАН України, Київ, Україна
- C1.17. Бекіров Б., Іванченко І., Попенко Н., Житлухіна О., Ламонова К., Орел С., Пашкевич Ю., Мельник А., Трачевський В., Паранчич Л.
Дослідження розбавлених магнітних напівпровідників HgSe:Fe зі змішаною валентністю методом ЕПР
Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України, Донецьк, Україна
- C1.18. Кислий В.П., Ліптуга А.І., Мороженко В.О., Піпа В.Й.
Визначення кута Фарадея в напівпровідникових плоскопаралельних шарах та структурах
Інститут фізики напівпровідників, Київ, Україна
- C1.19. Шуста О.В., Сливка О.Г., Гуранич П.П., Шуста В.С.
Вплив високого гідростатичного тиску на релаксаційну поведінку діелектричних властивостей кристалів $\text{CuCr}_x\text{In}_{1-x}\text{P}_2\text{S}_6$
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C1.20. Туровська Л.В., Бойчук В.М., Юрчишин Л.Д., Галушак М.О., Ткачук А.І.
Термодинаміка і кристалохімія точкових дефектів у термоелектричних кристалах телуридів олова, свинцю і германію
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
- C1.21. Грабар О.О., Стойка І.М., Пріц І.П., Молнар О.О., Ренгач К.М., Височанський Ю.М.
Фоторефрактивні властивості легованих сегнетонапівпровідникових кристалів $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{S}_6$
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C1.22. Попик Т.Ю., Шпенник О.Б., Попик Ю.В., Фейер В.М.
Низькоенергетична (0 - 10 eV) електронна спектроскопія поверхні напівпровідників
Інститут електронної фізики НАН України, Ужгород, Україна
- C1.23. Туровська Л.В., Бойчук В.М., Юрчишин Л.Д., Галушак М.О., Ткачук А.І.
Термодинаміка і кристалохімія точкових дефектів у термоелектричних кристалах телуридів олова, свинцю і германію
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
- C1.24. Карась Н.И.
Два взаємозв'язаних поверхностних фотоэффекта в макропористом кремнії

- Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева НАН Украины, Киев, Украина*
- C1.25. Тимочко М.Д., Оліх Я.М.
Дослідження електрично-активних дефектів методом імпульсної акустопровідності
Институт фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова, Київ, Україна
- C1.26. Nasieka Yu., Rashkovetskyi L., Strilchuk O., Moskvin P., Danilchenko B.
Effect of the thermal treatment on the photoluminescence properties of gamma-irradiated CdZnTe crystals
Lashkarev Institute of Semiconductor Physics, NASU, Kyiv, Ukraine
- C1.27. Товстюк К.К.
Порівняльний термодинамічний аналіз електронного газу у сильноанізотропних напівпровідниках для двох моделей $E(\vec{k})$
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
- C1.28. Беляев С.В., Даулетмуратов Б.К., Левицкий С.Н., Трищук Л.И.
Неконтролируемое загрязнение в детекторном CdTe
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины, Киев, Украина
- C1.29. Беляев С.В., Гнатюк В.А., Левицкий С.Н., Трищук Л.И.
Аннигиляция радиационных дефектов в детекторном CdTe
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарёва НАН Украины, Киев, Украина
- C1.30. Фелінський С.Г., Коротков П.А., Фелінський Г.С.
Вплив анізотропії на формування від'ємної діелектричної проникності в кристалах
Київський національний університет імені Тараса Шевченко, Київ, Україна
- C1.31. Воробкало Ф.М., Бабич В.М., Лучкевич М.М., Цмоць В.М.
Взаємозв'язок фотолюмінесценції, магнітної сприйнятливості та механічних властивостей у пластично деформованому кремнії
Институт фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- C1.32. Горощенко С.Я.
Закон дисперсии для поперечных колебаний в двумерных зигзаг-структурах зарядов
Институт теоретической физики им. Н.Н. Боголюбова НАН Украины, Киев, Украина
- C1.33. Воеводин С.В., Борисов А.В.
Использование лабораторной платформы NI ELVIS II для изучения п/п структур
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
- C1.34. Неймаш В.Б., Войтович В.В., Красько Н.Н., Колосюк А.Г., Кабалдін О.М., Руденко Р.М., Макара В.А., Юхимчук В.О., Стрельчук В.В.
Структура і оптичні властивості аморфно-кристалічних сплавів SiSn, виготовлених термічним розпиленням
Институт фізики НАН України, Київ, Україна
- C1.35. Северин В.С.
Вплив поляризації зарядів вільних електронів напівпровідника на поглинання ними світла
Національний авіаційний університет, Київ, Україна
- C1.36. Прислопский С., Тигиняну И., Гимпу Л., Монайко Э., Сырбу Л., Гапоненко С.

Эффект обратного светорассеяния в пористых полупроводниковых структурах

Институт физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь

СЕКЦІЯ 2

- C2.1. Карачевцева Л.А., Матвеева Л.О., Онищенко В.Ф., Сизов Ф.Ф., Стронська О.Й.
Електрооптичні ефекти в двовимірних структурах макропористого кремнію
Институт фізики напівпровідників ім.В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- C2.2. Krivoruchko V.N., Toichkin V. N.
First-principles calculation of spin-dependent tunneling conductance of an epitaxial $TbCo_5|Pr_2O_3|TbCo_5$ junction
Donetsk Physics and Technology Institute NAS of Ukraine, Donetsk, Ukraine
- C2.3. Бойчук В.І., Гольський В.Б., Сокольник О.А., Шаклеїна І.О.
Квантові переходи в гетероструктурах з двошаровими квантовими точками у формі витягнутих сфероїдів
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна
- C2.4. Ткач М.В., Матієк В.О., Фартушинський Р.Б.
Транспортні властивості трибар'єрних резонансно-тунельних структур зі зміщеними основами квантових ям
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
- C2.5. Сегі Ю.О., Бойко І.В., Войцехівська О. М.
Провідність електронного потоку крізь двобар'єрну наноструктуру з урахуванням міжелектронної взаємодії
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
- C2.6. Маханець О., Цюпак Н., Войцехівська О.
Екситонний спектр у складних шестигранних напівпровідникових нанотрубках
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
- C2.7. Гуцул В.І., Грищук А.М.
Потенціал поля поляризації та енергетичний спектр фононів у багатшарових наноплівках
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
- C2.8. Білинський І.В., Шевчук І.С.
Вплив поляризаційних фононів на електронні, діркові та екситонні стани у квантовій точці з виродженим зонним спектром
Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка, Дрогобич, Україна
- C2.9. Бойчук В.І., Білинський І.В., Сокольник О.А., Пазюк Р.І.
Вплив форми квантової точки на ймовірність оптичних переходів та коефіцієнт міжрівневих переходів
Дрогобицький державний педагогічний університет, інститут фізики, математики та інформатики, Дрогобич, Україна
- C2.10. Феодосьєв С.Б., Годованная Н.В., Господарев І.А., Котляр А.В., Кравченко К.В.

- Колебательные характеристики одномерных нанобразований в объеме и на поверхности кристаллов**
*Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина
НАН Украины, Харьков, Украина*
- C2.11. Господарев И.А., Feher A., Гришаев В.И., Котляр А.В., Кравченко К.В., Манжелий Е.В., Сыркин Е.С., Феодосьев С.Б.
Влияние локальных дефектов на электронный спектр графена
*Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина
НАН Украины, Харьков, Украина*
- C2.12. Конакова Р.В., Литвин О.С., Охрименко О.Б., Светличный А.М.
Оптические и морфологические характеристики слоев графена, полученных на подложках карбида кремния
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, Киев, Украина
- C2.13. Ананьїна О.Ю., Бутрїмов П.О., Северїна О.В.
Вплив точкових дефектів на енергетичні параметри адсорбції водню на графені
Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна
- C2.14. Тулупенко В.Н., Белых В.Г., Беличенко Я.Г.
Расчет волновых функций и энергетического спектра дырок в одномерных гетероструктурах
Донбасская государственная машиностроительная академия, Краматорск, Украина
- C2.15. Войцеховский А.В., Горн Д.И., Ижнин И.И., Ижнин А.И., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А.
Наблюдение анализ фотолюминесценции структуры КРТ с одиночной КЯ ($d=12,5$ нм, $x=0,24$)
Томский государственный университет, Томск, Россия
- C2.16. Бойчук В.І., Вороняк Л.Я., Вороняк Я.М.
Енергетичний спектр полярона складного квантового дроту GaN/ZnO/GaN у матриці AlN кристалів гексагональної симетрії
Дрогобицький державний педагогічний університет, інститут фізики, математики та інформатики, Дрогобич, Україна
- C2.17. Стрельчук В.В., Ніколенко А.С., Валах М.Я., Губанов В.О., Білий М.М., Булавін Л.А.
Особливості електрон-фононних резонансів в одношаровому графені та їх дослідження засобами резонансної мікро-КРС спектроскопії
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- C2.18. Белевский П.А., Винославский М.Н., Байдусь Н.В., Звонков Б.Н.
ИК излучение в гетероструктурах n -InGaAs/GaAs с квантовыми ямами в продольном электрическом поле
Институт физики НАН Украины, Киев, Украина
- C2.19. Дружинін А.О., Островський І.П., Ховерко Ю.М., Корецький Р.М.
Особливості магнітної сприйнятливості ниткоподібних кристалів Si
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
- C2.20. Калитчук С. М., Корбутяк Д. В., Токарев С. В., Ільчук Г. А., Токарев В. С.
Синтез та оптичні властивості нанокристалів CdS
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- C2.21. Ткаченко А.В., Мікаелян Г. Р.
Квантово-хімічне дослідження адсорбції кисню на поверхні Si(100)
Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна

- C2.22. Ліщинський І.М., Литвин П.М., Салій Я.П., Бачук В.В., Яворський Я.С.
Топологія та особливості процесів оствальдівського дозрівання в нанометрових шарах PbTe
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
- C2.23. Хархаліс Л.Ю., Берча Д.М., Шендеровський В.А.
Електрон-фононна взаємодія та особливості термоелектричних властивостей шаруватих халькогенідних кристалів
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C2.24. Охрименко О.Б., Беляев А.Е., Коломыс Ф.Ф., Конакова Р.В., Литвин О.С., Стрельчук В.В., Светличный А.М., Волков Е.Ю.
Спектры комбинационного рассеяния света пленок графена на подложках 6H-SiC
Институт фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- C2.25. Гуденко Ю.М., Пилипчук О.С., Вайнберг В.В., Порошин В.М., Чорноморець Н.Ф., Тулупенко В.М.
Магнітоопір гетероструктур $p\text{-Si}_{1-x}\text{Ge}_x/\text{Si}$ з дельта-легованими квантовими ямами
Институт фізики НАН України, Київ, Україна
- C2.26. Головацький В.А., Франків І.Б., Власенко М.
Еволюція електронного спектру у двошарових сферичних квантових точках з донорною домішкою при зміні ширини квантової ями
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
- C2.27. Власенко О.І., Велешук В.П., Бойко М.І.
Дослідження механізмів масопереносу на поверхні CdTe та GaAs при імпульсному лазерному наноструктуруванні
Институт фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- C2.28. Крамар В.М., Пуганцева О.В.
Вплив поляризації та екситон-фононної взаємодії на положення дна основної екситонної зони у наноплівці PbI₂
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
- C2.29. Товстюк К.К.
Залежність ширини забороненої зони у наноструктурі $\text{Zn}_{0,943}\text{Be}_{0,057}\text{Se}-\text{ZnSe}-\text{Zn}_{0,943}\text{Be}_{0,057}\text{Se}-\text{Zn}_{0,9}\text{Be}_{0,057}\text{Mn}_{0,05}\text{Se}$ залежно від її конфігураційних особливостей та прикладеного магнітного поля
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
- C2.30. Самодуров Д.А., Чертопалов С.В.
Барьер Шоттки на основе фуллерита C₆₀
Донецкий національний університет, Донецьк, Україна
- C2.31. Наумов А.В., Беляев А.Е., Витусевич С.А., Наумов В.В.
Диагностика и моделирование электронного транспорта в квантовых наноструктурах на основе нитридов GaN/AlGaN
Институт фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ, Київ, Україна
- C2.32. Пикалов А.А., Филь Д.В.
Образование стационарных волн в сверхтекучем газе магнитоэкситонов в двухслойных системах
Институт монокристаллов НАН, Харьков, Украина
- C2.33. Pl'chenko V.V., Pl'chenko L.G., Lobanov V.V.

About the electrostatic potential in the semiconductor - vacuum - metal contact

Radiophysical Department, Kiev Taras Shevchenko University, Kiev, Ukraine

C2.34. Сичікова Я.О., Кідалов В.В., Сукач Г.О.

Отримання надгратки pog-InP/mono-InP

Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ, Україна

C2.35. Омельченко С.А., Горбань А.А., Хмеленко О.В.

Спектроскопические исследования наноразмерного оксида цинка

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара,

Днепропетровск, Украина

C2.36. Пуга П.П., Попович К.П., Данилюк П.С., Красилицев В.Н., Пуга Г.Д., Турок И.И., Чичура И.И., Кельман В.А.

Рентгенолюминесценция поликристаллического тетрабората лития, активированного TbO_2

Институт электронной физики НАН Украины, Ужгород, Украина

C2.37. Shevchenko V. V., Makara V. A., Veblaya T. S., Dacenko O.I.

Peculiarities of Luminescent Nanostructured Silicon Forming in Water Solutions

Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv, Ukraine

C2.38. Шевченко В.Б., Макара В.А., Даценко О. І., Красножен Д.С.

Зміни фотолюмінесценції пористого кремнію при нанесенні нуклеїнових кислот на його поверхню

Київський національний університет ім Т. Шевченка, Київ, Україна

C2.39. Литвин Ю.М., Стадник О.А., Дубровін І.В., Литвин П.М., Прокопенко І.В., Оберемок О.С.

Електронно-емісійні властивості нанокристалів ZnO отриманих методом карботермічного синтезу

Институт фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна

C2.40. Примак М.В., Попович К.П. , Соломон А.М., Гоер Д.Б., Ажнюк Ю.М., Гомоннай О.В.

Спектри термостимульованої люмінесценції вкраплених у боросилікатне скло напівпровідникових нанокристалів $\text{CdS}_{1-x}\text{Se}_x$

Институт електронної фізики НАН України, Ужгород, Україна

СЕКЦІЯ 3

C3.1. Егоров В.В., Глауберман М.А., Канищева Н.А., Козел В.В.

Влияние неоднородности магнитного поля на разность коллекторных токов двухколлекторного магнитотранзистора

Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова, Одесса, Украина

C3.2. Курмашев Ш.Д., Викулин И.М., Стафеев В.И.

Електронні прибори на основі полуізоляторів

Одеська національна академія зв'язку, Одеса, Україна

C3.3. Наздеркин Е.А., Мазин А.С., Каравайников А.В.

Влияние оптического покрытия на эффективность фотоэлектрических элементов с аморфными полупроводниковыми слоями

Таврический национальный университет, Симферополь, Украина

C3.4. Войцеховский А.В., Несмелов С.Н., Дзядух С.М., Варавин В.С., Дворецкий С.А., Михайлов Н.Н., Сидоров Ю.Г., Якушев М.В.

Електрофізическіе і фотоелектрическіе свойства МДП-структур на основі гетероепітаксіального HgCdTe МЛЭ с неоднородным распределением состава

- Томский государственный университет, Томск, Россия*
- C3.5. Гниленко А.Б., Дзензерский В.А., Плаксин С.В., Погорелая Л.М.
Компьютерное моделирование кремниевых солнечных элементов с вертикальными p–n переходами
Институт транспортных систем та технологій НАН України «Трансмаг», Дніпропетровськ, Україна
- C3.6. Власенко Н.А., Олексенко П.Ф., Мухльо М.О., Литвин П.М., Велігура Л.І., Денисова З.Л.
Лазерна генерація в хвилеводній ZnS:Cr-структурі при електричній накачці з ударним механізмом збудження
Институт фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- C3.7. Вуйчик М.В., Лаворик С.Р., Цибрій З.Ф., Білевич Є.О., Свеженцова К.В.
Вирощування гетероструктур CdTe/PbTe та їх оптичні дослідження в ІЧ-діапазоні спектру
Институт фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- C3.8. Цибрій З.Ф., Забудський В.В., Вуйчик М.В., Кухтарук Н.І., Апатська М.В., Смолій М.І., Дмитрук Н.В., Бунчук С.Г., Андрєєва К.В.
Приймачі випромінювання ТГц/суб-ТГц діапазону спектра на основі CdHgTe
Институт фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- C3.9. Ющук С.І., Юр'єв С.О., Коломієць В.Й., Лобойко В.І., Дубельт С.П.
Перелаштовуваний надвисокочастотний генератор з резонатором на плівці залізо-ітрієвого граната
Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна
- C3.10. Возняк Ю.В., Новосядлий С.П., Сорохтей Т.Р., Кіндрат Т.П., Марчук С.М.
Моделі напівізолюючих арсенідгалієвих шарів при їх формуванні компенсуючою багатозарядною імплантацією
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
- C3.11. Кіндрат Т.П., Новосядлий С.П., Возняк Ю.В., Сорохтей Т.Р., Марчук С.М.
Особливості гетерної технології на GaAs-структурах
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
- C3.12. Карчевский Г., Махний В.П., Мельник В.В., Хуснутдинов С.В.
Фотоэлектрические свойства гетеропереходов ZnTe/CdTe, выращенных молекулярно-лучевой эпитаксией
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы, Украина
- C3.13. Ермоленко М.В., Станкевич В.В., Буганов О.В., Тихомиров С.А., Гапоненко С.В.
Полностью оптический модулятор для нескольких длин волн
Институт физики имени Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь
- C3.14. Кравців М.М., Бойчук В.І., Пелешак Р.М., Шпотюк О.Й.
Прикладні аспекти досліджень фотоелектретного стану в органічному полікристалічному напівпровіднику класу похідних дифенілу
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна.
- C3.15. Дмитриев А.И.
Ван-дер-Ваальсова поверхність InSe как стандарт нанорельефа в метрологии нанообъектов

- Институт проблем материаловедения им. И.М. Францевича НАН Украины, Киев, Украина*
- C3.16. Приходько А.В., Горбань А.Н.
Потери мощности ФЭП из рафинированного металлургического мультикристаллического кремния, вызванные паразитными омическими сопротивлениями
Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна
- C3.17. Оберемок О., Литовченко В., Хацевич І., Мельник В., Попов В., Гамов Д., Нікірін В.
Влияние имплантации ионов углерода на формирование кремниевых нанокластеров в SIMOX структурах
Институт фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- C3.18. Ваків М., Головчак Р., Чалий Д., Шпотюк М., Убізський С.
Особенности формирования валентных зон полупроводниковых стекол As-Ge-Se
Науково-виробниче підприємство „Карат”, Львів, Україна
- C3.19. Гавриш В.І.
Моделирование температурных режимов у конструктивных элементах микроэлектронных устройств из чужорідними наскрізними включеннями
Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна
- C3.20. Шевчик-Шекера А.В.
NER приемников излучения миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов. расчет их предельных значений
Институт фізики полупроводников ім. В.Е. Лашкарева НАН Украины, Киев, Украина
- C3.21. Пастушенко А., Сариков А., Климовская А.
Эволюция капель золота на поверхности кремния
Институт фізики полупроводников ім. В.Е. Лашкарьова НАНУ, Киев, Украина
- C3.22. Оліх О.Я., Онисюк С.В.
Особенности динамического ультразвукового влияния на γ -опромянені кремнієві *m-s*-структури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
- C3.23. Быткин С.В., Критская Т.В.
Радиационная деградация времени жизни неосновных носителей заряда в тиристорах на основе Cz-Si<P, Ge>
Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье, Украина
- C3.24. Бондаренко О.В., Степанов Д.М.
Самонесущий оптический кабель в условиях физико-климатических нагрузок
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова, Одеса, Україна
- C3.25. Птащенко О.О., Птащенко Ф.О., Довганюк Г.В.
Механизмы усиления поверхностного течения в *p-n* переходах, индуцированного адсорбционными процессами
Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Одеса, Україна
- C3.26. Сукач А.В., Тетьоркін В.В., Стратійчук І.Б., Шевченко М.В.
Механизмы формирования потенциального барьера в структурах Au/*p*-CdTe
Институт фізики НАН України, Київ, Україна
- C3.27. Кормош В., Алякшев И., Ивановская М., Оводок Е.
Полупроводниковые микросенсоры для контроля микроконцентраций CO в воздухе

- НДІ засобів аналітичної техніки Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна*
- C3.28. Abaskin V., Achimova E.
Using the optical code for simulation of the fiber-optic ESPI set-up design
Center of Optoelectronics, Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova
- C3.29. Мездрогина М.М.
Проблемы повышения эффективности твердотельного освещения на основе 111- нитридов
ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
- C3.30. Голубенко М.В., Мездрогина М.М., Разумов С.В.
Формирование спектров излучения внутрицентровых 4f переходов легирующих примесей РЗИ (Eu,Sm,Eg,Tm,Yb) в монокристаллических пленках ZnO
ФТИ им.А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург,Россия
- C3.31. Сингаївська Г.І., Коротєєв В.В.
Ефект анізотропії високочастотної провідності, що наведена електричним полем в компенсованому GaN
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарєва НАН України, Київ, Україна
- C3.32. Фелінський С.Г., Фелінський Г.С.
Антивідбиваючі канали у терагерцових спектрах кристалів
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
- C3.33. Chertopalov S., Tsukasa Yoshida
ZnO/polymer-fullerene hybrid solar cell
Donetsk National University, Donetsk, Ukraine
- C3.34. Нелюба П.Л., Венгер Е.Ф., Горбач Т.Я., Матвеева Л.А.
Преимущество микрорельефных гетероструктур в полупроводниковой технике
Інститут фізики полупроводников ім. В.Е. Лашкарєва НАН України, Киев, Украина
- C3.35. Беляев С.В., Гнатюк В.А., Левицкий С.Н., Кравецкий М.Ю.
Особенности производства μt в детекторном CdTe
Інститут фізики полупроводников ім. В.Е. Лашкарєва НАН України, Киев, Украина
- C3.36. Охрименко О.Б., Коломыс А.А., Конакова Р.В., Стрельчук В.В., Светличный А.М.
Спектры комбинационного рассеяния слоев пористого карбида кремния с нанесенной пленкой титана
Інститут фізики полупроводников ім. В.Е. Лашкарева НАН України, Киев, Украина
- C3.37. Мелебаев Д.
Фоточувствительность наноструктур Au-окисел- n - $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{P}$ в УФ области спектра
Физико-математический институт АН Туркменистана, Ашхабад, Туркменистан
- C3.38. Ташлиева А.М.
Фоточувствительность структур Au- p -GaP p -типа
Физико-математический институт Академии наук Туркменистана, Ашхабад, Туркменистан
- C3.39. Тихонов А.М.
Планарні кремнієві світловипромінюючі матриці для діапазону 3-12 мкм

- Институт фізики напівпровідників ім В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна*
- C3.40. Salzenstein P., Cholley N., Hmima A., Zarubin M., Pavlyuchenko E., Galliou S., Chembo Y., Larger L.
Phase noise optoelectronic metrology system for microwaves photonics sources
Franche Comté Electronique Thermique Optique Sciences et Technologies, Besançon, France
- C3.41. Сохацкий В., Шулимов Ю., Колесник С.
Влияние спинового клапана на протекание тока в спиновом транзисторе
Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Киев, Украина
- C3.42. Бормашов В.С., Буга С.Г., Корнилов Н.В., Тарелкин С.А., Терентьев С.А.
Диоды Шоттки на основе тонких гомоэпитаксиальных пленок на синтетических монокристаллах алмаза
ФГУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов», г. Троицк, Россия
- C3.43. Vorzobova N.D., Bulgakova V.G., Burunkova Yu.E., Moskalenko A.I.
The process of periodic structures fabrication in nanocomposite materials
St. Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics, Optics, St. Petersburg, Russia

СЕКЦІЯ 4

- C4.1. Бондар М.В., Бродин М.С.
Прояв структури перколяційного кластера в спектрах фотолюмінесценції квантових точок ZnSe в низькодielekтричній матриці
Институт фізики НАН України, Київ, Україна
- C4.2. Балабай Р.М.
Пассивация эпитаксиальных структур CdHgTe: розрахунки із перших принципів
Криворізький державний педагогічний університе, Кривий Ріг, Україна
- C4.3. Терлецкая Л.Л., Копыт Н.Х., Голубцов В.В.
Диагностика эпитаксиальных слоев фосфида галлия методом компьютерной диэлькометрии
Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова, Одесса, Украина
- C4.4. Новиков В.А., Хрипунов Г.С., Копач Г.И., Шкалето В.И.
Физико-технологические основы газовых датчиков адсорбционно-полупроводникового типа на основе пленок оксида олова
Национальный технический университет «ХПИ», Харьков, Украина
- C4.5. Прокопьев Е.П., Графутин В.И., Тимошенко С.П.
Возможное влияние нанобъектов на свойства полупроводников по данным позитронных аннигиляционных спектров
ИТЭФ, Москва, Россия.
- C4.6. Гуранич О.Г., Стефанович В.О., Ясінко Т.І., Риган М.Ю., Штець П.П., Рубіш В.М.
Природа кристалічних включень в матриці стекел системи Sb₂S₃-AsSI
Ужгородський НТЦ МОНІ ІПРІ НАН України, Ужгород, Україна
- C4.7. Малик О.П., Кеньо Г.В.
Взаємодія носіїв заряду з близькодійним потенціалом дефектів в нітриді галію
Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна
- C4.8. Рибак О.В., Біленька О.Б.
Технологія вирощування та оптична діагностика кристалів PbI₂, легованих міддю

- С4.9. *Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна*
Ключко Н.П., Хрипунов Г.С., Волкова Н.Д., Копач В.Р., Любов В.М.,
Копач А.В., Кудій Д.А.
**Структура і фізичні властивості шарів кадмій сульфід, одержаних
рідиннофазним хімічним осадженням**
*Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», Харків, Україна*
- С4.10. Карачевцева Л.А., Покровський В.О., Литвиненко О.О., Паршин К.А.,
Северинівська О.В., Орел І.Л.
**Іонізаційна підкладка на основі макропористого кремнію для лазерно-
десорбційної мас-спектрометрії**
Інститут фізики напівпровідників ім.В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ,
Україна
- С4.11. Курмашев Ш.Д., Викулин І.М., Снина І.І.
**2D- електронний газ в приповерхностних шарах $Cd_xHg_{1-x}Te$ при
воздействию радиации**
Одеська національна академія зв'язку, Одеса, Україна
- С4.12. Курмашев Ш.Д., Бугаєва Т.Н., Лавренова Т.І., Садова Н.Н.
**Перколяційні токи в гетерофазних композитах «стекло-кластери
Ag-Pd»**
Одеська національна академія зв'язку, Одеса, Україна
- С4.13. Рубіш В.М., Риган М.Ю., Гасинець С.М., Штець П.П., Шпирко Г.М.
**Одержання, структура і властивості композитів з сегнетоелектричними
властивостями на основі халькогенідних стекел**
Ужгородський НТЦ МОНІ ІПРІ НАН України, Ужгород, Україна
- С4.14. Gentsar P.O., Vlasenko O.I., Vuichyk M.V., Zayats M.S., Kyselyuk M.P.,
Kryskov Ts.A.
**Characteristics of optical reflection of thin GaSe/n-Si(100) and GaSe/n-Si(111)
films in visible and infrared spectral regions**
V. Lashkaryev Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
- С4.15. Генцарь П.О., Власенко О.І., Вуйчик М.В., Заяць М.С., Киселюк М.П.,
Криськов Ц.А., Кругленко І.В., Свеженцова К.В.
Особливості росту та оптичні дослідження тонких плівок InSe/n-Si
*Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ,
Україна*
- С4.16. Генцарь П.О., Власенко О.І., Вуйчик М.В., Гнатюк В.А., Заяць М.С.,
Левицький С.М., Насека Ю.М., Стрільчук О.М., Маслов В.П.
**Оптичні дослідження високоомних монокристалів CdTe та твердих
розчинів $Cd_{1-x}Zn_xTe$ ($x = 0,1$)**
*Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ,
Україна*
- С4.17. Бурлак Г.М., Вилинская Л.Н.
**Спектральні характеристики свечення окисних плінок тантала в
контакте с электролитом**
*Одесская государственная академия архитектуры и строительства, Одесса,
Украина*
- С4.18. Раранський М.Д., Балазюк В.Н., Мельник М.І., Хандожко В. О.
**Структурна стабільність та характер хімічного зв'язку ізоаніонного ряду
напівпровідникових сполук $ZnTe \rightarrow CdTe \rightarrow HgTe$**
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Чернівці, Україна
- С4.19. Гуцул І.В., Гуцул В.І.
**Особливості нестационарного розподілу температури анізотропного
термoelementa при імпульсному збудженні**

- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна*
- C4.20. Власенко Н.А., Олексенко П.Ф., Сопінський М.В., Денисова З.Л., Велігура Л.І., Гуле Є.Г., Мухльо М.А.
Електронні стани на поверхні кремнію після напилення та відпалу плівки SiO_x
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
- C4.21. Власенко Н.А., Сопінський М.В., Гуле Є.Г., Братусь В.Я., Стрельчук В.В., Велігура Л.І., Ніколенко А.С., Мухльо М.А.
Вплив легування фторидом ербію на структуру та фотолюмінесценцію плівок SiO_x
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Київ, Україна
- C4.22. Третяк А.П., Божко В.В., Давидюк Г.С., Булатецька Л.В., Парасюк О.В., Семенюк С.А.
Залежність оптичних та фотоелектричних параметрів твердих розчинів AgCd_{2-x}Mn_xGaSe₄ від природи і концентрації структурних дефектів
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна
- C4.23. Линник А.В., Безрядин Н.Н., Котов Г.И.
Исследование наноразмерных полупроводниковых пленок на поверхности подложек из A^{III}B^V методом динамического зонда Кельвина
Воронежская государственная технологическая академия, Воронеж, Россия
- C4.24. Ивановская М.И., Котиков Д.А.
Синтез, структура, магнитные и электропроводящие свойства нанокомпозитов SiO₂-Fe₂O₃
НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь
- C4.25. Котов Г.И., Безрядин Н.Н., Кузубов С.В., Власов Ю.Н., Кортунов А.В., Панин Г.А.
Структурно-фазовые превращения и электронные процессы на поверхности полупроводников A^{III}B^V после обработки в парах селена
Воронежская государственная технологическая академия, Воронеж, Россия
- C4.26. Манілов А.І., Скришевський В.А., Алексеев С.О., Кузнецов Г.В.
Вплив сорбції молекулярного водню на імпеданс мембран поруватого кремнію та його композитів з паладієм
Інститут високих технологій, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Київ, Україна
- C4.27. Коротаев А.Г., Войцеховский А.В., Григорьев Д.В., Коханенко А.П., Тарасенко В.Ф., Шулепов М.А.
Исследование влияния объемного наносекундного разряда в воздухе атмосферного давления на электрофизические свойства эпитаксиальных пленок CdHgTe
Томский государственный университет, Томск, Россия
- C4.28. Слетов М.М., Ткаченко И.В., Черных Е.И., Ульяницкий К.С.
Оптические свойства гетероструктур CdSe/CdTe
Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, Черновцы, Украина
- C4.29. Коханенко А.П., Турапин А.М., Войцеховский А.В., Коротаев А.Г.
Молекулярно-лучевая эпитаксия Ge/Si наногетероструктур с квантовыми точками
Томский государственный университет, Томск, Россия
- C4.30. Оводок Е.А., Ивановская М.И.

- Особенности структуры и сенсорные свойства гетерофазных нанокомпозитов $\text{In}_2\text{O}_3\text{-SnO}_2$**
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
- C4.31. Литвин П.М., Трунов М.Л., Дячинська О.М., Прокопенко І.В.
Роль фотостимульованого поверхневого потенціалу у формуванні рельєфних ґраток в халькогенідних стеклах
Інститут фізики напівпровідників НАН України, Київ, Україна
- C4.32. Литвин П.М., Литвин О.С., Корчовий А.А., Литвин Ю.М., Гриценко К.П., Прокопенко І.В.
Механічна зондова літографія для створення наноструктур різного призначення
Інститут фізики напівпровідників НАН України, Київ, Україна
- C4.33. Brus V.V.
Comparison of optical properties of TiO_2 thin films prepared by magnetron sputtering and electron-beam evaporation techniques
Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, NASU, Chernivtsi, Ukraine
- C4.34. Луканюк М. В., Мар'янчук П.Д., Майструк Е.В.
Температурний коефіцієнт зміни ширини оптичної забороненої зони кристалів $\text{Hg}_{1-x-y}\text{Mn}_x\text{Fe}_y\text{Te}$
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
- C4.35. Козярський І.П., Мар'янчук П.Д., Майструк Е.В.
Температурна залежність ширини забороненої зони $(3\text{HgSe})_{0.5}(\text{In}_2\text{Se}_3)_{0.5}$, легованого 3d-елементами
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
- C4.36. Савчук С.А., Столярчук І.Д., Клето Г.І., Савчук А.Й., Ткачук В.І.
Морфологія поверхні та оптичні спектри тонких плівок оксидів ZnCoO , ZnNiO
Чернівецький національний університет, Чернівці, Україна
- C4.37. Савчук А.Й., Ткачук П.М., Столярчук І.Д., Савчук О.А., Смолінський М.М.
Структурні властивості нанокристалів ZnO та ZnMnO синтезованих методом лазерної абляції в рідині
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці, Україна
- C4.38. Смолінський М.М., Савчук А.Й., Ткачук П.М., Ткачук В.І., Гарасим В.І.
Вплив концентрації прекурсорів на оптичні властивості нанокристалічних порошків ZnO , синтезованих ультразвуковою розпорошуючою технікою
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці, Україна
- C4.39. Медулич М.М., Стефанович В.О., Євич Р.М., Височанський Ю.М.
Ефекти ангармонізму в спектрах комбінаційного розсіювання світла сегнетоелектрика з трьохямним потенціалом
Ужгородський національний університет, Ужгород, Ужгород
- C4.40. Попович В.Д., Bester M., Вірт І.С., Kuzma M., Білик М.Ф.
Визначення часів життя носіїв заряду у вирощених сублімацією монокристалах CdTe:Cl методом нестационарної фотопровідності
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, Дрогобич, Україна
- C4.41. Якимчук О.В., Мирончук Г.Л., Парасюк О.В., Давидюк Г.Є.
Електричні і оптичні властивості тетрарних халькогенідних сполук AgGaGeS_4
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна

- C4.42. Курило І.В., Льчук Г.А., Лукашук С.В., Рудий І.О., Українець В.О., Чекайло М.В.
Механічні властивості полікристалічних шарів телуриду кадмію
Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна
- C4.43. Росул Р.Р., Гуранич П.П., Гомоннай О.О., Сливка О.Г., Роман І.Ю., Риган М.Ю., Гомоннай О.В.
Фазові переходи низьковимірних сегнетоелектриків $\text{PIn}(\text{S}_{0.99}\text{Se}_{0.01})_2$
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C4.44. Onanko A.P., Kulish M.P., Lyashenko O.V., Prodayvoda G.T., Vyzhva S.A., Onanko Y.A., Kiselyuk M.P.
Control of defect nanostructure from internal friction background in Si + SiO₂ plates
Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, Ukraine
- C4.45. Onanko A.P., Kulish M.P., Lyashenko O.V., Prodayvoda G.T., Vyzhva S.A., Onanko Y.A., Kiselyuk M.P.
Influence of mechanical treatment, changing of defect nanostructure on internal friction in Si and SiO₂
Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, Ukraine
- C4.46. Горічок І.В., Писклинець У.М.
Напівемпіричні методи розрахунку енергій утворення вакансій у напівпровідниках II-VI
Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Україна
- C4.47. Ащеулов А.А., Гуцул І.В., Маник О.М., Маник Т.О.
Дослідження температурних залежностей енергетичних характеристик твердих розчинів CdSb-ZnSb
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
- C4.48. Ащеулов А.А., Маник О.М., Савчук А.Й., Білинський-Слотило В.Р.
Дослідження структури та хімічного зв'язку FeSe
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
- C4.49. Берченко М.М., Фадєєв С.В., Василечко Л.О., Савчин В.П.
Порівняльний аналіз процесів термічного оксидування вузькощілинних напівпровідників $\text{A}^{\text{II}}\text{B}^{\text{VI}}$ та $\text{A}^{\text{IV}}\text{B}^{\text{VI}}$
Національний університет „Львівська політехніка”, ІТРЕ, Львів, Україна
- C4.50. Шевчук В.Н., Усатенко Ю.М.
Дослідження ЕПР нано- та монокристалів V₂O₅
Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна
- C4.51. Ievtushenko A.I., Lashkarev G.V., Lazorenko V.I.
The influence of oxygen pressure on ZnO:Al films properties
Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, NASU, Kyiv, Ukraine
- C4.52. Мілованов Ю.С., Гаврильченко І.В., Кузнецов Г.В., Скришевський В.А.
Інжекційні струми в гетероструктурах оксид титану – кремній
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
- C4.53. Savkina R. K.
Semiconductor surface modification as a result of the acoustic cavitation
V.Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics at NAS of Ukraine, Kiev, Ukraine
- C4.54. Удовицькая Р.С., Савкина Р.К., Сизов Ф.Ф., Смирнов А.Б.
Свойства структур $n\text{-Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}/\text{CdZnTe}$ ($x=0,223$) разупорядоченных ионной имплантацией B^+ и Ag^+
Институт физики полупроводников им. Лашикарева НАН Украины, Киев, Украина

- C4.55. Смірнов О. Б.
Вплив спеціальних обробок на стан поверхні та властивості телуриду кадмію
Інститут фізики напівпровідників НАН України, Київ, Україна
- C4.56. Терещенко А.В., Кусевич А., Вітер Р.В., Сминтина В.А.
Вплив літію на структурні та оптичні властивості оксидтитанових нановолокон, отриманих методом електроспінінгу
Одесский національний університет ім. І. І. Мечникова, Одесса, Україна
- C4.57. Наконечний І.Й., Фочук П.М., Панчук О.Е.
Електричні властивості детекторних кристалів $Cd_{0,9}Zn_{0,1}Te$ за високих температур
Чернівецький національний університет, Чернівці, Україна
- C4.58. Дикун Н.І., Запухляк Р.І., Терлецький А.І., Фрик О.Б.
Комірка для вимірювання параметрів термоелектричних матеріалів стаціонарним методом
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
- C4.59. Новосад О.В., Божко В.В., Давидюк Г.Є., Козер В.Р., Парасюк О.В.
Фоточутливість структур $In/n-Cu_{1-x}Zn_xInS_2$ ($x=0,04-0,12$)
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна
- C4.60. Герасимик О.Р., Божко В.В., Новосад О.В.
Електропровідність та термо-ЕРС твердих розчинів $CuInSe_2-CdS$
Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Україна
- C4.61. Росул Р.Р., Гуранич П.П., Гомоннай О.О., Сливка О.Г., Роман І.Ю., Риган М.Ю., Гомоннай О.В.
Барична поведінка діелектричних властивостей сегнетоелектриків-напівпровідників $TlIn(S_{0,97}Se_{0,03})_2$
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C4.62. Фур'єр М.С., Буківський П.М., Гамерник Р.В., Гнатенко Ю.П., Вертигел І.Г., Овчаренко О.І.
Енергетична та кристалічна структура твердих розчинів $Pb_{1-x}Cd_xI_2$
Інститут фізики НАН України, Київ, Україна
- C4.63. Паранчич Л.Д., Макогоненко В.Н., Андрійчук М.Д., Романюк В.Р., Окулов В.І., Говоркова Т.Е., Лончаков А.Т., Окулова К.А., Подгорных С.М.
Эффекты гибридизации электронных состояний примесей кобальта в селениде ртути
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
- C4.64. Курило І.В., Ільчук Г.А., Лукашук С.В., Рудий І.О., Українець В.О., Чекайло М.В.
Механічні властивості полікристалічних шарів телуриду кадмію
Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна
- C4.65. Хомяк В.В., Сльотов М.М., Косоловський В.В., Сльотов О.М.
Люмінесцентні властивості шарів ZnO
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці, Україна
- C4.66. Баскевич А.С., Буланый М.Ф., Дяденко А.И., Коваленко А.В., Омельчук А.Р., Полозов К.Ю., Скуратовская Е.В.
Физические свойства тонких пленок ZnO , выращенных на альтернативных подложках методами MOCVD и CVD
Днепропетровский национальный университет ім. О. Гончара, Днепропетровск, Украина
- C4.67. Bilanych R., Kohutych A., Molnar A., Samulionis V., Perechinskii S., Motrya S., Stoika I., Vysochanskii Yu.

Griffiths phases on state diagram of $\text{Sn}(\text{Pb})_2\text{P}_2\text{S}(\text{Se})_6$ ferroelectrics

Institute of Physics and Chemistry of Solid State, Uzhgorod National University, Uzhgorod, Ukraine

- C4.68. Иванов В.М., Трубицын Ю.В.
Поисковые лабораторные исследования катализаторов для гидрирования тетрахлорида кремния
Классический частный университет, Запорожье, Украина
- C4.69. Ліщинський І.М., Соколов О.Л., Потяк В.Ю., Лоп'янок М.А., Литвин П.М.
Механізми росту і топологія наноструктур на основі кадмії телуриду
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
- C4.70. Поперенко Л.В., Лендел В.В., Одарич В.А., Раков М.В., Юргелевич І.В.
Діагностика тонких плівок оксиду цинка еліпсометричним методом
Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Київ, Україна
- C4.71. Ільченко В.В., Телега В.М., Кулик С.П., Коваленко В.С.
Вплив іонного бомбардування на морфологію поверхні плівок SnO_2
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
- C4.72. Гнатюк Д.В., Поперенко Л.В., Юргелевич І.В., Левицький С.М.
Атомно-силова мікроскопія та еліпсометрія монокристалів $\text{CdTe}(111)$ після лазерної та хімічної обробки
Київський національний університет ім. Т.Шевченка, Київ, Україна
- C4.73. Прокопів В.В.
Вплив умов вирощування на дефектну підсистему плівок плумбум селеніду
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
- C4.74. Shchurova T.N., Klevets V.Yu., Savchenko N.D., Orachko I.I., Slivka A.G., Rorovic K.O.
Electronic structure for Mn-doped $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{Se}_6$ compounds
Uzhgorod National University, Uzhgorod, Ukraine
- C4.75. Милян П.М., Семрад Е.Е., Милян Ж.И., Кун А.В., Соломон А.М.
Термодинамический анализ тройной системы Pb-Sb-O
НДІ фізики і хімії твердого тіла УжНУ, Ужгород, Україна
- C4.76. Милян Ж.И., Хижун О.Ю.
Електронні властивості шпінелей $\text{Cu}_2\text{B}^{\text{II}}\text{Ti}_3\text{S}_8$ ($\text{B}^{\text{II}}-\text{Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cd}$).
НДІ фізики і хімії твердого тіла УжНУ, Ужгород, Україна
- C4.77. Хміль Д.Н., Камуз А.М., Олексенко П.Ф., Камуз В.Г., Алексенко Н.Г., Камуз О.А.
Определение коэффициента поглощения композитных пленок из фотолуминофорных суспензий
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева, Киев, Украина
- C4.78. Риган М.Ю., Гасинець С.М., Микайло О.А., Горіна О.В., Elouadi B., Соломон А.М.³, Рубіш В.М.
Дослідження кристалізації стекол системи $\text{As}_2\text{Se}_3\text{-SbSeI}$
Ужгородський НТЦ МОНІ ІПРІ НАН України, Ужгород, Україна
- C4.79. Гера Е.В., Поп М.М., Мар'ян В.М., Трунов М.Л., Дуркот М.О., Гуранич О.Г., Рубіш В.М.
Фотостимульовані ефекти в аморфних плівках $(\text{As}_2\text{S}_3)_{47}(\text{SbSI})_{53}$
Ужгородський НТЦ МОНІ ІПРІ НАН України, Ужгород, Україна
- C4.80. Хміль Д.Н., Камуз А.М., Олексенко П.Ф., Камуз В.Г., Алексенко Н.Г., Камуз О.А.
Математическая модель композитной пленки из фотолуминофорной суспензии

- Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева, Киев, Украина*
С4.81. Фомин А.В., Кравецкий М.Ю., Пашенко Г.А.
Исследование эволюции дефектов рельефа поверхности подложек при химико-механическом полировании
- Институт физики полупроводников НАН Украины, Киев, Украина*
С4.82. Фомин А.В., Кравецкий М.Ю., Пашенко Г.А.
Фотолюминесценция в пористом GaAs, полученном методом химического травления
- Институт физики полупроводников НАН Украины, Киев, Украина*
С4.83. Sarikov A.
Strain effect on the phase separation in non-stoichiometric silicon oxide films
V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
- С4.84. Критская Т.В., Матюшин. В.М., Жавжаров Е.Л.
Влияние среды на выращивание монокристаллов Si на $\tau_{\text{низ}}$
Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье, Украина
- С4.85. Сафрюк Н.В., Кладько В.П., Кучук А.В., Литвин П.М., Мачулин В.Ф.,
Беляев О.С.
Рентгеноструктурні дослідження багаточарових III-нітридних структур
Институт фізики напівпровідників ім В.Є. Лашкарєва НАН України, Київ, Україна
- С4.86. Солнцев В.С., Горбанюк Т.И., Литовченко В.Г.
Адсорбційні та електрофізичні властивості наноструктурованого оксиду вольфраму
Институт фізики напівпровідників НАН України, Київ, Україна
- С4.87. Коломієць І. С., Савенков С. М., Оберемок Є. А.
Умови ортогональності власних поляризацій для однорідних середовищ з комбінацією двох видів анізотропії
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
- С4.88. Шевченко И.В., Оксанич А.П., Тербан В.А.
Интеллектуальные системы мониторинга процесса выращивания монокристаллов
Кременчугский национальный университет, Кременчуг, Украина
- С4.89. Оксанич А.П., Седин Е.А.
Разработка метода для исследования деформаций кремниевых эпитаксиальных структур
Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского, Кременчуг, Украина
- С4.90. Козьма А.А., Переш Є.Ю., Барчій І.Є., Беца В.В., Попик Ю.В., Цигика В.В.
Термоелектричні властивості проміжних сплавів квазіпотрійної системи $\text{Te}_2\text{Se}-\text{SnSe}_2-\text{Bi}_2\text{Se}_3$
НДІ ФХТТ, Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- С4.91. Бачериков Ю.Ю., Жук А.Г., Оптасюк С.В., Охрименко О.Б., Кардашєв К.Д.,
Козицкий С.В.
Роль различных низкоэнергетических воздействий на люминесцентные характеристики ZnS:Mn , полученного методом одностадийного синтеза
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарєва НАН України, Киев, Украина
- С4.92. В.М. Варварук, І.М. Ліщинський, П.М. Литвин, О.В. Стронський, І.Г. Кабан,
В.М., Кланічка, М.М. Ілин
Термодинаміка і структура халькогенідних стекол As_2S_3 , $\text{As}_2\text{S}_3-\text{Ag}$, $\text{As}_2\text{S}_3-\text{AgI}$
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаніка, Івано-Франківськ, Україна

- C4.93. Далекорей А.В., Іваницький В.П., Ковтуненко В.С., Мешко Р.О.
Проблеми моделювання атомної структури неупорядкованих напівпровідникових плівок
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C4.94. Шпотюк М.В., Шпотюк О.Й., Балицька В.О.
Фотоіндуковане дефектоутворення в тонких плівках халькогенідів миш'яку
Науково-виробниче підприємство „Карат”, Львів, Україна
- C4.95. Bureau B., Calvez L., Golovchak R., Shpotyuk O.
Structure of Se-based vitreous semiconductors by solid state ^{77}Se nuclear magnetic resonance spectroscopy.
University of Rennes, Rennes, France
- C4.96. Kavetskyu T., Tsmots V., Pankiv L., Petkova T., Kolev K., Petkov P., Stepanov A.
On the concentration of paramagnetic centers per cluster and magnetic ordered clusters in ion-conducting Ag/AgI-As₂S₃ chalcogenide glasses
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych, Ukraine
- C4.97. Kavetskyu T., Jóvári P., Kaban I., Yannopoulos S.N., Borc J., Wang W., Chen G., Ecker H., Stepanov A.
Structural investigations of chalcogenide glasses from the GeS₂-In₂S₃-AgI system
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych, Ukraine
- C4.98. Кришеник В.М., Мікла В.І.
Фотоіндуковані динамічні ефекти в аморфних плівках As-S
НДІ ФХТТ, Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C4.99. Кондрат О., Попович Н., Голомб Р., Лямаєв В., Цуд Н., Петраченков О., Литвин П., Литвин О., Міца В.
Лазерно індукована трансформація в приповерхневих наночастицях плівок As_xSe_(100-x) (x=40, 50)
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C4.100. Студеняк І.П., Шпак О.І., Матіюк І.М.
Оптико-рефрактометричний аналіз кристалічного і скловидного CdAs₂
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C4.101. Поп М.М., Євич Р.М., Перечинський С.І., Шпак І.І., Височанський Ю.М.
Мандельштам-бріллюенівське розсіювання світла в скловидних сплавах системи As-Sb-S
НДІ ФХТТ Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C4.102. Holomb R., Mitsa V., Akyuz S., Akalin E.
Formation and characterization of Ge_nSe_m nanoclusters by results of *ab initio* DFT calculations.
Institute of Solid State Physics and Chemistry, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine
- C4.103. Паюк О.П., Стронський О.В., Губанова А.О., Криськов Ц.А., Олексенко П.Ф.
Вплив легуючої домішки на магнітні властивості As₂Se₃
Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАНУ, Київ, Україна
- C4.104. Тихонов А.М.
Планарні кремнієві світловипромінюючі матриці для діапазону 3-12 мкм
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ 03028 Україна
- C4.105. Гасинець С.М., Соломон А.М., Гуранич О.Г., Ясінко Т.І., Перевузник В.П., Шпирко Г.М., Гомоннай О.В., Рубіш В.М.
Особливості одержання і кристалізації стекел в системі As₂S₃-Sn₂P₂S₆

- Ужгородський НТЦ МОНІ ІПРІ НАН України, Ужгород, Україна
- C4.106. Гера Е.В., Штець П.П., Рубіш В.М., Горват Ю.А.
Структура і властивості стеклокерамики системи $As_2S_3-As_2Se_3$ та $As_2S_3-Sb_2S_3$
Ужгородський НТЦ МОНІ ІПРІ НАН України, Ужгород, Україна
- C4.107. Горіна О.В., Риган М.Ю., Микайло О.А., Varj M., Bih L., Соломон А.М.,
Перевузнник В.П., Пісак Р.П., Опачко І.І.
Стекляні композити в системі Se-SbSI
Ужгородський НТЦ МОНІ ІПРІ НАН України, Ужгород, Україна
- C4.108. Колбунов В.Р., Каменецкий В.В., Ивон А.И., Куницкий Ю.А.,
Черненко И.М.
Микроструктура и фазовый состав полупроводниковой стеклокерамики системы $VO_2-VFC-Cu_2O-SnO_2$
Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, Украина.
- C4.109. Мица В.М., Рудько Г.Ю., Гуле Є.Г., Фекешгазі І.В., Голомб Р.М.
Фотолумінесценція в широкозонних напівпровідникових стеклах при кімнатній температурі
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C4.110. Косяков А.В., Завражнов А.Ю., Наумов А.В., Сергеева А.В., Березин С.С.
Равновесие в системе Ga-I по данным высокотемпературных спектрофотометрических исследований
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
- C4.111. Махний В.П., Кинзерская О.В., Слетов М.М., Герман И.И.
Определение энергии ионизации ν в ZnSe
Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича Черновцы, Украина
- C4.112. Кизяк А.Ю., Евтух А.А., Педченко Ю. Н., Братусь О.Л.
Электропроводность пленок SiO_x и $SiO_2(Si)$ полученных методом LP CVD
Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева НАН Украины, Киев, Украина
- C4.113. Лоя В.Ю., Стойка В.І., Петришинець І.І., Соломон А.М., Крафчик С.С.,
Красилинець В.М.
Дослідження тонких плівок As_2S_3 скануючим електронним мікроскопом
Институт електронної фізики НАН України, Ужгород, Україна
- C4.114. Мица В.М., Рудько Г.Ю., Гуле Є.Г., Фекешгазі І.В., Голомб Р.М.
Фотолумінесценція в широкозонних напівпровідникових стеклах при кімнатній температурі
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C4.115. Лукша О.В.
Лазерно-плазмове модифікування наноструктури і властивостей аморфних напівпровідників
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
- C4.116. Ажнюк Ю.М., Примак М.В., Гутич Ю.І., Лопушанський В.В., Боднар І.В.,
Турок І.І., Гомоннай О.В., Цан Д.Р.Т.
Отримання й оцінка параметрів потрійних і четвірних телуровмісних нанокристалів типу A^2B^6 у боросилікатному склі
Институт електронної фізики НАН України, Ужгород, Україна
- C4.117. Фекешгазі І., Боркач Є., Ловас Г., Балог З., Петраченков О.
Порівняльний аналіз променевої стійкості халькогенідних стеклокерамики та плівок одержаних в різних технологічних умовах
Институт фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна

- C4.118. Горічок І.В., Гургула Г.Я., Прокопів В.В. (мол.), Бойчук В.М., Фреїк Н.Д.
Точкові дефекти і фізико-хімічні властивості кристалів халькогенідів кадмію і цинку
Фізико-хімічний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна
- C4.119. Штеплюк І.І., Лашкар'юв Г.В., Хомяк В.В., Мар'янчук П.Д., Тимофєєва І.І., Майструк Е.В., Кафанов А.М., Лазоренко В.Й.
Закономірності впливу технологічних умов осадження на мікроструктуру і оптичні властивості плівок $Zn_{0.9}Cd_{0.1}O$
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ, Україна
- C4.120. Борча М.Д., Кройтор О.П., Кшевецкий О.С., Савчук А.В., Фодчук И.М.
Характеризация структурных дефектов на границах раздела гетероструктур по данным многоволновой рентгеновской дифрактометрии
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы
- C4.121. Борча М.Д., Баловсяк С.В., Кройтор О.П., Ткач В.Н., Фодчук И.М.
Тензометрия упругих деформаций на границах раздела многослойных наноразмерных систем с помощью дифракции отраженных электронов
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы
- C4.122. Фодчук І.М., Фесів І.В., Новіков С.М., Польовий В.П.
Х-променева інтерферометрія структурних порушень у кристалах та неоднорідностей біологічних об'єктів
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
- C4.123. Піч У., Давидок А.В., Пашняк Н.В., Фодчук І.М., Каземірський Т.А., Заплітний Р.А., Гуцуляк І.В., Бончик О.Ю., Савицький Г.В., Сиворотка І.І., Яремій І.В.
Модифікація дефектної структури залізо-ітрієвих гранатів під впливом високодозової імплантації
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
- C4.124. Новиков С.Н., Струк А.Я., Фодчук И.М., Федорцов Д.Г.
Особенности рассеяния рентгеновских лучей на сильных деформационных полях вблизи линий дислокаций
Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, Черновцы, Украина